

MAGNETORESISTIVE ELEMENT AND MAGNETIC MEMORY

Patent Number: JP2003008105
Publication date: 2003-01-10
Inventor(s): ODAKAWA AKIHIRO; MATSUKAWA NOZOMI; SUGITA YASUNARI
Applicant(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
Requested Patent: JP2003008105
Application Number: JP20010190984 20010625
Priority Number(s):
IPC Classification: H01L43/08; G01R33/09; G11B5/39; G11C11/14; H01F10/16; H01F10/32; H01L27/105
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a field-effect magnetoresistive element and a preferable example of device constitution.

SOLUTION: This magnetoresistive element is composed of a first magnetic body with which the element is constituted by attaching a magnetic spin suppressing layer to the body, and a second magnetic body which is not in contact with a magnetic spin layer. Conductivity control is performed by connecting the first and second magnetic bodies to each other through a conductor which mainly rules ballistic conduction, and by impressing an electric field upon the conductor or urging the conductor to induce carries. The second magnetic body which is not in contact with the magnetic spin layer is utilized for a magnetic memory, reconfigurable circuit, etc., as a free magnetic body.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-8105

(P2003-8105A)

(43)公開日 平成15年1月10日(2003.1.10)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード*(参考)
H 0 1 L 43/08		H 0 1 L 43/08	Z 2 G 0 1 7
G 0 1 R 33/09		G 1 1 B 5/39	5 D 0 3 4
G 1 1 B 5/39		G 1 1 C 11/14	A 5 E 0 4 9
G 1 1 C 11/14		H 0 1 F 10/16	5 F 0 8 3
H 0 1 F 10/16		10/32	

審査請求 未請求 請求項の数8 O L (全 21 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-190984(P2001-190984)

(22)出願日 平成13年6月25日(2001.6.25)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 小田川 明弘

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 松川 望

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

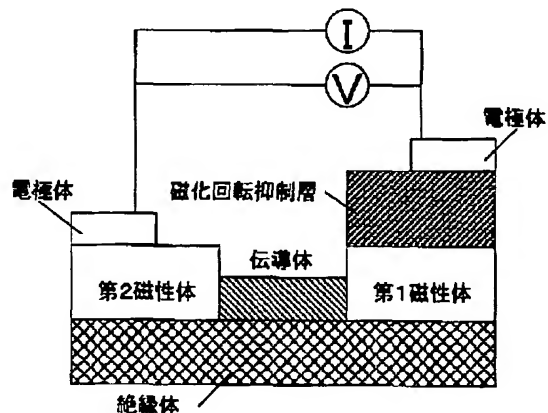
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 磁気抵抗素子および磁気メモリ

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 電界効果型の磁気抵抗素子とその好ましいデバイス構成例を提供する。

【解決手段】 磁化回転抑制層をつけて磁気抵抗素子を構成した第1の磁性体と磁気回転層に接していない第2の磁性体からなり、磁性体間を主としてバリスティック伝導を司る伝導体にて接続し、伝導体に電界印可あるいはキャリア誘起を促し、伝導性制御を行う。磁化回転層に接していない第2の磁性体を自由磁性体として磁気メモリやリコンフィギャラブル回路などに利用する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも2つの磁性体のうち、磁化回転抑制層が接した第1磁性体と前記磁化回転抑制層に接していない第2磁性体とが少なくとも1つの伝導体を介して接しており、且つ前記伝導体を挟む2つの磁性体の磁化相対角の変化により抵抗が変化することを特徴とする磁気抵抗素子。

【請求項2】 少なくとも2つの磁性体のうち、磁化回転抑制層が接した第1磁性体と前記磁化回転抑制層と絶縁体を挟むようにして配され、かつ前記磁化回転抑制層に接していない第2磁性体とが、少なくとも1つの伝導体を介して接しており、且つ前記伝導体を挟む2つの磁性体の磁化相対角の変化により抵抗が変化することを特徴とする特徴とする磁気抵抗素子。

【請求項3】 少なくとも2つの磁性体のうち、磁化回転抑制層が接した第1磁性体と前記磁化回転抑制層に接していない第2磁性体とが少なくとも1つの伝導体を介して接しており、前記伝導体の内少なくとも1つが、電子またはホール注入あるいは誘起により前記伝導体を挟む2つの磁性体間の電気抵抗が変化することを特徴とする磁気抵抗素子。

【請求項4】 前記磁化回転抑制層が、反強磁性体または積層フェリ磁性体または高保持力磁性体から選ばれた少なくとも1つからなることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の磁気抵抗素子。

【請求項5】 前記伝導体が、Si細線であることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の磁気抵抗素子。

【請求項6】 少なくとも2つの磁性体のうち、磁化回転抑制層が接した第1磁性体と前記磁化回転抑制層に接していない第2磁性体とが少なくとも1つの伝導体を介して積層体を構成しており、且つ前記伝導体を挟む2つの磁性体の磁化相対角の変化により抵抗が変化することを特徴とする磁気抵抗素子。

【請求項7】 前記伝導体が、炭素チューブであることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載の磁気抵抗素子。

【請求項8】 請求項1～7のいずれかに記載の磁気抵抗素子と、前記第2磁性体への磁界印可の手段と前記第2磁性体の磁化方向を読み取る手段とを、それぞれ複数個備えた磁気メモリであり、前記磁気メモリは半導体基板上に集積された半導体スイッチ素子上に配置され、少なくとも前記磁気メモリの読み取り時あるいは書き込み時に接続されていることを特徴とする磁気メモリ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、情報通信端末などに使用される光磁気ディスク、ハードディスク、デジタルデータストリーマ(DDS)、デジタルVTR等の磁気記録装置の再生ヘッド、回転速度検出用の角速度磁気セ

ンサー、応力変化、加速度変化などを検知する応力または加速度センサーあるいは熱や化学反応による磁気抵抗効果の変化を利用した熱センサーや化学反応センサーに代表される磁気抵抗センサーや、磁気ランダム・アクセス・メモリ(MRAM)、リコンフィギュラブルメモリなどに代表する磁気固体メモリ、あるいは磁気による電流スイッチ(磁気スイッチ)素子、さらには電圧スイッチ素子等関するものである。

【0002】

【従来の技術】磁性を用いたメモリは、磁性体の有するスピンの情報をメモリとして蓄える故に、不揮発なメモリを実現でき、これからの省電力・高速情報端末の実現に優れたデバイスの一つであると考えられている。これまでに、非磁性膜を介して交換結合した磁性膜より成る人工格子膜が、巨大磁気抵抗効果(GMR)を示すことが発見され(M. N. Baibich et.al., Phys. Rev. Lett. 61 (1988) 2472.)、GMR膜を用いたMRAMの提案もなされた(K. T. M. Rammuthu et.al., IEEE Trans. on Magn. 29 (1993) 2593.)。前記のGMR膜の非磁性層はCu等の導体膜であるが、非磁性層に Al_2O_3 等の絶縁膜を用いたトンネル型GMR膜(TMR)の研究も盛んとなり、このTMR膜を用いたMRAMも提案されている。TMR膜を用いたMRAMはGMR膜のものよりも大きな出力と高密度メモリの実現が期待されている。それに伴い、DRAM等の高密度メモリの代替の可能性も検討され始めており、将来の超高密度メモリを目指した、数ナノから数十ナノメートルサイズでのアーキテクチャの確立が待たれている。数ナノから数十ナノメートルサイズのように、伝導に量子的な影響が強く表れるようサイズ領域になると、従来とは一線を画する素子アーキテクチャが必要とされる。磁性を用いたメモリは、量子であるスピンの情報をメモリとして蓄えているため、スピン情報を直接伝送する、あるいは、伝送スピンを直接制御するといった、新しい素子および回路を提案できるのではないかと期待されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】これまで、スピンの情報を直接伝送するためには、従来のTMR素子のように極薄のトンネルバリアを磁性体間に配して偏極スピントンネル現象を利用することしか実現できていない。これでは、伝送スピンを直接制御するような新しい回路は形成できない。

【0004】本発明は、かかる課題に対して、スピンの伝送経路を長くし、伝送経路にバリスティックな伝導を可能にする伝導体を用い、その好ましい材料と配置を提供することにより実現する磁気抵抗素子およびそのデバイス構成例を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため、本発明は、少なくとも2つの磁性体のうち、磁化回

転抑制層が接した第1磁性体と前記磁化回転抑制層に接していない第2磁性体とが少なくとも1つの伝導体を介して接しており、且つ前記伝導体を挟む2つの磁性体の磁化相対角の変化により抵抗が変化することを特徴とする磁気抵抗素子であり、前記磁化回転抑制層に接していない磁性体を自由磁性体として情報を記録し読み出す磁気メモリや、磁気抵抗効果部の抵抗変化を利用したリコンフィギュアブル回路等、様々な磁気デバイスとして利用することができる。

【0006】また本発明は、少なくとも2つの磁性体のうち、磁化回転抑制層が接した第1磁性体と前記磁化回転抑制層と絶縁体を挟むようにして配され、かつ前記磁化回転抑制層に接していない第2磁性体とが、少なくとも1つの伝導体を介して接しており、且つ前記伝導体を挟む2つの磁性体の磁化相対角の変化により抵抗が変化することを特徴とする特徴とする磁気抵抗素子であり、前記磁化回転抑制層に接していない磁性体を自由磁性体として情報を記録し読み出す磁気メモリや、磁気抵抗効果部の抵抗変化を利用したリコンフィギュアブル回路等、様々な磁気デバイスとして利用することができる。

【0007】また本発明は、少なくとも2つの磁性体のうち、磁化回転抑制層が接した第1磁性体と前記磁化回転抑制層に接していない第2磁性体とが少なくとも1つの伝導体を介して接しており、前記伝導体の内少なくとも1つが、電子またはホール注入あるいは誘起により前記伝導体を挟む2つの磁性体間の電気抵抗が変化することを特徴とする磁気抵抗素子であり、前記磁化回転抑制層に接していない磁性体を自由磁性体として情報を記録し読み出す磁気メモリや、磁気抵抗効果部の抵抗変化を利用したリコンフィギュアブル回路等、様々な磁気デバイスとして利用することができる。

【0008】本発明に関して、磁化回転抑制層が、反強磁性体または積層フェリ磁性体または高保持力磁性体から選ばれた少なくとも1つからなるのが好ましい。

【0009】また、一つの実施形態において伝導体として、炭素チューブを用いるのが好ましい。

【0010】また、一つの実施形態において伝導体として、Si細線を用いるのが好ましい。

【0011】また本発明は、少なくとも2つの磁性体のうち、磁化回転抑制層が接した第1磁性体と前記磁化回転抑制層に接していない第2磁性体とが少なくとも1つの伝導体を介して積層体を構成しており、且つ前記伝導体を挟む2つの磁性体の磁化相対角の変化により抵抗が変化することを特徴とする磁気抵抗素子であり、前記磁化回転抑制層に接していない磁性体を自由磁性体として情報を記録し読み出す磁気メモリや、磁気抵抗効果部の抵抗変化を利用したリコンフィギュアブル回路等、様々な磁気デバイスとして利用することができる。

【0012】ここでも、一つの実施形態において伝導体として、炭素チューブを用いるのが好ましい。

【0013】またさらに本発明は、磁気抵抗素子と前記第2磁性体への磁界印可の手段と前記第2磁性体の磁化方向を読み取る手段とを、それぞれ複数個備えた磁気メモリとして動作し、半導体基板上に集積された半導体スイッチ素子上に配置され、少なくとも本発明の磁気抵抗素子を用いた磁気メモリの読みとり時あるいは書き込み時に半導体スイッチ素子部に接続されて動作する磁気メモリを実現できる。

【0014】

【発明の実施の形態】本発明の磁気抵抗素子について図を用いて説明を行う。

【0015】まず、図1は、磁化回転抑制層、第1磁性層、第2磁性層、伝導層で構成されている。ここでの伝導層は主としてスピン偏極電子が、バリスティック的に、あまり散乱を受けずに伝導を行える伝導層として設けたものである。磁化回転抑制層と接した第1磁性層は固定層として、接していない第2磁性層は自由層として磁気抵抗素子を構成している。素子の抵抗を検出する際には第1磁性層および第2磁性層に電極体を配して行う。図1のように磁化回転抑制層が伝導層でもある場合には磁化回転抑制層上に電極体を配してもよい。

【0016】第1磁性層は、磁化回転抑制層と接することで、磁気的に結合し、磁化回転を困難とすることが望ましい。この際の磁化回転抑制層は高保持力磁性体、積層フェリ磁性体、反強磁性体あるいは積層フェリ磁性体と反強磁性体の多層膜であるのが好ましい。

【0017】前記構成の高保持力磁性体としては、CoPt, FePt, CoCrPt, CoTaPt, FeTaPt, FeCrPtなどの保持力が1000e以上である材料が好ましい。

【0018】また反強磁性体としては、PtMn, PtPdMn, FeMn, IrMn, NiMn等が好ましい。

【0019】また積層フェリ磁性体としては、磁性体と非磁性体の多層構造を持ち、ここで用いられる磁性体として、CoまたはCoを含んだFeCo, CoFeNi, CoNi, CoZrTa, CoZrB, CoZrNb合金等を用い、また非磁性体としては、Cu, Ag, Au, Ru, Rh, Ir, Re, Osあるいはこれらの金属の合金、酸化物を用いるのが好ましい。

【0020】一方で第2磁性層は、第1磁性層に比べて容易な磁化回転を実現し、自由磁性層とする。

【0021】2つのスピン偏極した磁性体同士をバリスティック的な伝導が可能な伝導体を介してバイアス印可した場合、2つの磁性体間での磁化相対角の変化を、その抵抗変化として検知することができる。このことは、バリスティック伝導体中を伝わるスピン偏極電子が、スピン散乱をあまり受けずに伝導し、接続された磁性体界面で、そのスピン偏極方向に依存して反射されるために起こる現象と考えられる。

【0022】この際に、本発明のように一方を磁化回転抑制層にて接し、固定磁性層とし、もう一方を磁化回転抑制層にて接していない自由磁性層することにより、磁

化相対角を明瞭にし、その結果高出力を得ことができる。

【0023】図2は図1で示した基本の磁気抵抗素子の動作の様子を模式的に示している。

【0024】図2(a)、図2(b)のように、定電圧バイアス印可のもとでは、2つの磁性体のそれぞれの磁化方向が平行の場合に比べて、そうでない場合の素子に流れる電流値が低下する。

【0025】また、図2(c)、図2(d)のように、定電流バイアス印可のもとでは、2つの磁性体のそれぞれの磁化方向が平行の場合に比べて、そうでない場合の素子に流れる電圧が増加する。

【0026】ここで、第1磁性層または第2磁性層に用いられる材料としては、Fe、Co、Ni、FeCo合金、NiFe合金、CoNi合金、NiFeCo合金、あるいは、FeN、FeTiN、FeAlN、FeSiN、FeTa₂N、FeCoN、FeCoTiN、FeCo(Al,Si)N、FeCoTa₂N等の窒化物、酸化物、炭化物、硼化物、フッ化物磁性体に代表されるTMA(Tは、Fe、Co、Niから選ばれた少なくとも1種、Mは、Mg、Ca、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Al、Si、Mg、Ge、Gaから選ばれた少なくとも1種、またAは、N、B、O、F、Cから選ばれた少なくとも1種)、あるいは(Co、Fe)M(MはTi、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cu、Bから選ばれた少なくとも1種)、あるいはFeCr、FeSiAl、FeSi、FeAl、FeCoSi、FeCoAl、FeCoSiAl、FeCoTi、Fe(Ni)(Co)Pt、Fe(Ni)(Co)Pd、Fe(Ni)(Co)Rh、Fe(Ni)(Co)Ir、Fe(Ni)(Co)Ru、FePt等に代表されるTL(TはFe、Co、Niから選ばれた少なくとも1種、LはCu、Ag、Au、Pd、Pt、Rh、Ir、Ru、Os、Ru、Si、Ge、Al、Ga、Cr、Mo、W、V、Nb、Ta、Ti、Zr、Hf、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luから選ばれた少なくとも1種)等の強磁性体、またあるいは、Fe₃O₄あるいはXMnSb(Xは、Ni、Cu、Ptから選ばれた少なくとも一つ)、LaSrMnO₃、LaCaSrMnO₃、CrO₂に代表されるハーフメタル材料、あるいは、QDA(QはSc、Y、ランタノイド、Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、Znから選ばれた少なくとも1種、AはC、N、O、F、Sから選ばれた少なくとも1種、Dは、V、Cr、Mn、Fe、Co、Niから選ばれた少なくとも1種)、あるいはGaMnN、AlMnN、GaAlMnN、AlBMnN等のRDA(Rは、B、Al、Ga、Inから選ばれた1種、Dは、V、Cr、Mn、Fe、Co、Niから選ばれた1種、AはAs、C、N、O、P、Sから選ばれた1種)等に代表される磁性半導体、あるいは、ペロブスカイト型酸化物、フェライト等のスピネル型酸化物、ガーネット型酸化物が好ましい。

【0027】また絶縁体は絶縁性材であれば何れでも良いが、特にMg、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Crを含むIIa~Vla、La、Ceを含むランタノイド、Zn、B、Al、Ga、Siを含むIIb~IVbから選ばれた元素と、F、O、C、N、Bから選ばれた少なくとも元素との化合物、あるいはポリイミドやフタロシアニン系有機分子材料であることが好ましい。

【0028】また伝導体としては、スピン散乱の小さいバリスティック伝導体として用いるために伝導体の幅、厚みは共に100nm以下であることが好ましい。特に室温近傍での動作のためには伝導体の幅・厚みは50nm以下であることがより好ましい。そのような特性を有する伝導体として炭素チューブを用いるのが好ましい。炭素チューブは、単層から多層のものまで種々存在するが、ここではいずれを用いても良い。また、数ナノメートルから数十ナノメートルの幅の高濃度キャリアドープしたSi細線を用いるのが好ましい。また、半導体基体を用いて作成したMOS(Metal-Oxide-Semiconductor)型FET(電界効果トランジスタ)構造あるいはMES(Metal-Semiconductor)型FET構造において形成したチャネル部分を伝導体として構成しても良い。その際にはソース部、ドレイン部は磁性体で構成されていることが好ましく、磁性体は磁性半導体であるのが更に好ましい。また、伝導体の長さは1nm以上1000nm以下であるのが好ましい。

【0029】また電極体は、好ましい材料として非磁性導電性材料、Cu、Al、Ag、Au、Pt、TiNを初め、抵抗率が100μΩcm以下の材料であれば何れでも良い。特に炭素チューブに対してはAuあるいはCr/Auが好ましい。

【0030】また一つの実施の形態として、図3(a)のように、絶縁基体上に磁化回転抑制層が一部配置され、その上に第1磁性体、絶縁基体上に第2磁性体、2つの磁性体間を伝導体が段差形状を横切るように配置されて構成されている。ここでの伝導層体はバリスティック的な伝導を行う伝導体として設けて磁気抵抗素子を構成する。磁化回転抑制層と接した第1磁性体は固定層として、接していない第2磁性体は自由層として磁気抵抗素子を構成している。

【0031】この際、図3(b)のように、絶縁基体上に配置された磁化回転抑制層の端部が傾斜をもって形成されるのが好ましい。このように配置した場合、伝導体の層厚がその角度によって制御できる上で好ましい。特に、好ましくは、角度を25度から70度が適している。この範囲であるとき、最も再現性良く、磁気抵抗素子を作成できた。炭素チューブを用いる場合にも、この範囲にあるとき、炭素チューブの端部での折れ曲がり、その伝導特性が与える影響が少なく好ましい。この際に、この好ましい角度範囲での曲面を有した斜面形状であっても良い。

【0032】また、図3(c)は、磁化回転抑制層上に絶縁体の一部が配置され、その上に第2磁性体、磁化回転抑制層に直接接するように第1磁性体、2つの磁性体間を伝導体が段差形状を横切るように配置されて構成されている。ここでの伝導体はバリスティック的な伝導を行う伝導体として設けたものである。磁化回転抑制層と接した第1磁性体は固定層として、接していない第2磁性体は自由層として磁気抵抗素子を構成しており、好ましい。

【0033】磁化回転抑制層と伝導体が直接接する場合には、磁界回転抑制層は半導体あるいは絶縁体であることが好ましい。

【0034】ここで、図3(d)は図3(a)の、図3(e)は図3(b)の、図3(f)は図3(c)の上面配置図の様子をそれぞれ示している。

【0035】図4(a)は非磁性基体中に磁化回転抑制層が一部に形成され、その上に第1磁性体、絶縁基体直上に第2磁性体、2つの磁性体間に伝導体が配置されて構成されている。ここでの伝導体はバリスティック的な伝導を行う伝導体として設けたものである。磁化回転抑制層と接した第1磁性体は固定層として、接していない第2磁性体は自由層として磁気抵抗素子を構成している。

【0036】図4(b)は非磁性基体中に磁性層が一部に少なくとも2つ以上形成され、そのうち2つの磁性層間に伝導体が配置され、第1磁性層上の一部に磁化回転抑制層が配置されて構成されている。ここでの伝導体はバリスティック的な伝導を行う伝導体として設けたものである。磁化回転抑制層と接した第1磁性層は固定層として、接していない第2磁性層は自由層として磁気抵抗素子を構成している。

【0037】この際、図4(c)のように、第1磁性層上に伝導体を上下で挟み込むように磁性体をさらに積層し、その上に磁化回転抑制層を接触させる方が、第1磁性体を固定層として用いるのに更に好ましい。また第1磁性体および第2磁性体の上に配する磁性体は金属磁性体であることが好ましく、電気的接触が得られやすい上で本配置が好ましい。

【0038】また、図4(d)のように、非磁性基体中に磁性層が一部に少なくとも2つ以上形成され、そのうち2つの磁性層間に伝導層が形成され、第1磁性層上の一部に磁化回転抑制層が配置されて構成されている。ここでの伝導体はバリスティック的な伝導を行う伝導層として設けたものである。磁化回転抑制層と接した第1磁性層は固定層として、接していない第2磁性層は自由層として磁気抵抗素子を構成している。

【0039】図4(a)で示した非磁性基体中に形成される磁化回転抑制層は、強磁性あるいは反強磁性を有する磁性半導体にて形成されるのが好ましい。この際、この磁性半導体は基板と同種の元素を少なくとも一つ有し、同種の結晶構造を有するものが好ましい。

【0040】図4(a)、図4(b)、図4(c)、図4(d)で示した磁気抵抗素子において第1磁性層と第2磁性層間の伝導は主として伝導体を介して行われるのが好ましく、その意味から非磁性基体は絶縁性基板または半導体基板であるのが好ましい。

【0041】図4(b)、図4(c)、図4(d)で示した非磁性基体中に形成される第1磁性層および第2磁性層は、強磁性を有する磁性半導体にて形成されるのが

好ましい。この際、この磁性半導体は基板と同種の元素を少なくとも一つ有し、同種の結晶構造を有するものが好ましい。

【0042】ここでも磁化回転抑制層と伝導体が直接接する場合には、磁界回転抑制層は半導体あるいは絶縁体であることが好ましい。

【0043】図5は三端子素子として構成した磁気抵抗素子を示している。

【0044】ゲート電界印可のために伝導体上に絶縁体を介して電極体が配されている。ここでは便宜上、第1磁性体側をドレイン部、第2磁性体側をソース部として示している。

【0045】ゲート電極と伝導体との間に配した絶縁体としては絶縁性材であれば何れでも良いが、特にMg, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Crを含むIIa~VIa, La, Ceを含むランタノイド, Zn, B, Al, Ga, Siを含むIIb~IVbから選ばれた元素と、F, O, C, N, Bから選ばれた少なくとも元素との化合物であるのが好ましい。またフタロシアニン系有機分子材料であっても良い。

【0046】図6は図5で示した基本の三端子構造の磁気抵抗素子の動作の様子を模式的に示している。

【0047】図6(a)のように、第1磁性層と第2磁性層の磁化方向が平行の場合、ゲート電圧を印可しないときには、スピン偏極電子は伝導体を伝わり、磁性体間に一定の電圧バイアスを印可した下では、磁性体間に電流が流れやすい。一方、図6(b)のように、ゲート電圧を印可した場合においては、キャリアが伝導体に誘起され、スピン散乱を促すことにより、検知される磁性体間の電流量は低下する。この際、ゲート電圧に対する素子の抵抗は、図21(a)の様に变化する。

【0048】また、図6(c)のように、第1磁性層と第2磁性層の磁化方向が反平行の場合においては、ゲート電圧を印可しないとき、スピン偏極電子は伝導体を伝わりにくく、一定電圧バイアス印可の下では、磁性体間に電流が流れにくい一方で、図6(d)のようにゲート電圧を印可した場合においては、キャリアが伝導体に誘起され、スピン散乱を促すことにより、実効的にスピン反転した電子が増し、検知される磁性体間の電流量は増加する。この際、ゲート電圧に対する素子の抵抗は、図21(b)の様に变化する。

【0049】この様な三端子構造の磁気抵抗素子は、図7(a)に示すように、図3(a)の伝導体上に絶縁体を介して電界印可用の電極体が配して構成できる。ここでは、図3(a)を用いて示したが、図3(b)、図3(c)を用いても三端子素子が構成できる。

【0050】また、図7(b)のように、図4(a)の伝導体上に絶縁体を介して電界印可用の電極体が配して構成できる。ここでは、図4(a)を用いて示したが、図4(b)、図4(c)を用いても三端子素子が構成できる。

【0051】また、図7(c)のように、図4(d)の伝導体上に絶縁体を介して電界印可用の電極体が配して構成できる。ここではMOS構造あるいはショットキーバリアを介したようなMES構造において形成されるチャネル部分が伝導体として機能する。その際にはソース部、ドレイン部は磁性体で構成されていることが好ましく、磁性体は磁性半導体であるのが更に好ましい。

【0052】更に、図5の配置だけでなく、ゲート電極部を図7(d)のように配しても、好ましい。

【0053】ここで、磁性半導体とは、QDA(QはSc, Y, ランタノイド, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Znから選ばれた少なくとも1種、AlはC, N, O, F, Sから選ばれた少なくとも1種、Dは、V, Cr, Mn, Fe, Co, Niから選ばれた少なくとも1種)、あるいはGaMnN, AlMnN, GaAlMnN, AlBMnN等のRDA (Rは、B, Al, Ga, Inから選ばれた1種、Dは、V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni から選ばれた1種、AlはAs, C, N, O, P, Sから選ばれた1種)等に代表されるものから選択される。

【0054】図8は積層体でのバリスティック伝導を用いた磁気抵抗素子の様子を示している。

【0055】図8(a)のように磁化回転抑制層に接した第1磁性体と接していない第2磁性層の間にバリスティック伝導を担う伝導体配した構成を示している。この様な構成は、図8(b)のように多数の伝導体を配して構成しても良い。また、図8(c)のように多数の伝導体の周辺に非磁性絶縁体を配して構成するのが好ましい。

【0056】また図8(d)のように第2磁性体を第1磁性体に点接触させて構成しても、効果がある。更に別な形態として、図8(e)のように磁性体を伸張させて一部にくびれた細い領域を形成しても同様の効果が得られるため好ましい。この際の伸張部分は少なくとも50nm以下であるのが好ましい。これらの場合、接触部分あるいは伸張部分は超常磁性状態にあり、主としてバリスティック伝導体として機能する。

【0057】図8(a)、図8(b)、図8(c)にて示した伝導体として炭素チューブを用いる場合には、炭素チューブ配向膜作成に適したバッファ層を用いるのが好ましく、磁性膜としても機能するのが最も好ましい。ここでの磁性膜としてはFe、Co、Niが炭素チューブ配向に相応しく、本発明の磁気抵抗素子として、特に $\text{Fe}_x\text{Co}_y\text{Ni}_z$ ($0.1 \leq x \leq 1.0$, $0 \leq y \leq 0.8$, $0 \leq z \leq 0.9$, $x+y+z=1$)を用いるのがさらに好ましい。

【0058】上記本発明の構成は、通常の薄膜プロセスと微細加工プロセスを用いて、実現できる。各磁性層、反強磁性層、層間絶縁層、電極等の形成には、パルスレーザデポジション(PLD)、イオンビームデポジション(IBD)、クラスターイオンビームまたはRF、DC、ECR、ヘリコン、ICPまたは対向ターゲットなどのスパッタリング法、MBE、イオンプレーティング

法等のPVD法や、その他CVD、メッキ法あるいはゾルゲル法で作製することができる。

【0059】また微細加工としては、半導体プロセスや、GMRヘッド作製プロセス等で用いられるイオンミリング、RIE、FIB等の物理的あるいは化学的エッチング法や、微細パターン形成のためにステッパー、EB法等を用いたフォトリソグラフィ技術を組み合わせることで達成できる。また電極等の表面平坦化のために、CMPや、クラスターイオンビームエッチングを用いることも効果的である。

【0060】また前記構成の磁気抵抗素子を使用することで、読み出し時に高出力を得る磁気メモリが作製できる。

【0061】図12に上記構成の磁気抵抗素子をメモリ素子として用いた磁気メモリの例を示す。メモリとして使用される素子としては、前記構成の磁気抵抗素子の何れの構成でもよい。素子は例えば図12のM(i, j)に代表されるように、CuやAlをベースに作られた記録線であるビット線とワード線の交点にマトリクス様に配置され、それぞれのラインに信号電流を流した時に発生する合成磁界を用いた2電流一致方式により信号情報が記録される。ビット線およびワード線の素子の記録層に対する距離が異なる場合には、素子動作にとって効率的な磁界が記録層に印可するように両線に電流を印可する。

【0062】次に、このアドレッシングの時間を高速化した場合、あるいは記録線間の間隔が狭まることで、記録線同士において誘導結合電流もしくは、容量性結合電流が発生し、もう一つ別の形態のクロストークが生じることがある。これらを抑制する1つの方法として、図17に示したように、記録線間の間に接地された結合線を設けることが好ましい。図17(a)は結合線をワード線に対して横に配置した場合、あるいは別な形態として、図17(b)のように磁気抵抗素子を挟み込む配置の場合を示している。図17(b)の場合においては、磁界が記録層である自由層に集中しやすく好ましい。また、微細化が進むにつれて、配線厚みが配線幅に比べて大きくなり、縦長の断面形状を持つようになるため、図17(a)のような配置の方が結合が取りやすく好ましい。このような結合線を図13(b)の磁気メモリデバイスにおいて実現した場合、配線配置は図18のような構成となる。

【0063】まず、図13および図14において、磁気メモリデバイスの電流による書き込み動作と、読み込み動作の基本例について説明する。尚、それぞれの図では例として図1に示した磁気抵抗素子をメモリ素子として用いている。

【0064】図13(a)および図13(b)では、素子の磁化状態を個別に読みとるために、素子毎にFETに代表されるスイッチ素子を設けた構成を示している。この磁気メモリは、CMOS基板上に容易に構成できる。また

図13(c)および図13(d)では、素子毎に非線形素子、あるいは整流素子を用いた構成を示している。ここで、非線形素子は、バリスタや、トンネル素子、あるいは前記構成の3端子素子を用いても良い。この磁気メモリは、ダイオードの成膜プロセスなどを増やすだけで、基板を安価がガラス基板上にも作製可能である。ここで、図13(a)および図13(c)は記録層2つとともに素子の上部に、図13(b)および図13(d)は素子の上部・下部に配置した場合の例を示している。また図14では、図13の各図に示したような素子分離のためのスイッチ素子、あるいは整流素子などを用いず、直接ワード線とビット線の交点に素子が配置される構成としている。従って、図14では、読み出し時に複数の素子にまたがって電流が流れるために、読み出しの精度から、10000素子以下であることが望ましい。10000素子以上では、出力が十分得られなくなる。

【0065】図13の各図では、それぞれ、ビット線は素子に電流を流して抵抗変化を読みとるセンス線と併用する場合について示しているが、ビット電流による誤動作や素子破壊を防ぐため、センス線とビット線を別途設けてもよい。このときビット線は、素子と電氣的に絶縁された位置で且つ、センス線と平行に配置することが好ましい。また、電流書き込みの場合、ワード線、ビット線とメモリセル間の距離は消費電力の点から500nm程度以下であることが望ましい。

【0066】次に図15および図16に、電流磁界による書き込みを行う、多層配線メモリのセル構造例を示す。図15はFETに代表されるスイッチ素子上に作製した多層配線で、また図16はダイオードやトンネル素子に代表される整流素子あるいは非線形素子を介して形成した多層配線を示す。スイッチ素子や整流素子または非線形素子は、隣接する素子同士の電氣的分離を行う働きをする。これらの電氣的分離素子がない多層配線の場合、センス感度から、最大個数10000個のメモリセルの集合体を1ブロックとするアーキテクチャを採る必要がある。

【0067】また、ここで説明した磁気抵抗素子の出力検出時には、図19のような検出回路を用いることで実現できる。例えば、配線抵抗を含めた比較抵抗との出力差をとることで、配線抵抗および基準素子抵抗をキャンセルすることができたため、高S/N化が容易に実現できる上で好ましい。

【0068】磁気メモリを構成した場合、比較抵抗は、図20で示したように配置すれば、所望の磁気メモリを構成できる。

【0069】ここで用いられる磁界発生用のワード線やビット線には、導電性が高く、臨界電流密度が $10^6 - 10^7$ A/cm²とエレクトロマイグレーションに強いCuを主として用いるのが好ましい。さらに、臨界電流密度が 10^3 A/cm²である炭素チューブを主として用いるのも、高磁界発

生に有効であり、好ましい。

【0070】更に具体的な実施の例を以下に示す。

【0071】(実施例1) まず、SOI (Silicon on Insulator) /SiO₂基板を用いて、Siの細線を作成した。

【0072】熱酸化と湿式エッチングにより薄膜化したSOI層を熱酸化してSOI(20)/SiO₂(25)を形成した。ここで、SiO₂(25)自体をレジスト体として利用し、EB(電子ビーム)加工を施し、5-50nmの幅を有する細線パターン描画を行った。この際の描画に用いたDose量は1-10C/cm²であった。現像にはバッファードフッ酸(HF=0.2mol/l、NH₄=0.2mol/l)を用いて行った。この後、RIE(反応性イオンエッチング)を行って、SOI層を加工し、再び、バッファードフッ酸を用いてレジスト体のSiO₂層を除去し、所望の5-50nmサイズのSiの細線を得た。この後、PSG(リンケイ酸ガラス)を用いてのリンの熱拡散を800℃で約10分程度行い、細線全体にドーピングして導電性を与えた。この際のキャリア濃度は、 $10^{17} - 10^{21}$ /cm³にした。更にSi細線作成後に、細線表面に熱酸化によって1-5nm程度の絶縁酸化膜を作成した。続いて、薄いアモルファスSi層を瞬時熱酸化を行って、径が2-10nm程度のSiドットを細線上に形成した。これにより、単電子チャージングの効果が誘起され、バリスティック的な、あるいはコトンネル的な伝導効果が期待される。この微細加工部分に通常の有機レジスト体を堆積し(図9(a))、その上に多層スパッタを用いて以下の要領でサンプルを作製した。

【0073】サンプル1

Ta(1)/CoFe(15)/Ta(15)

(カッコ内の単位はnm)

図9(b)に示したような、このサンプルにリフトオフなどの工程を通じて、図9(c)に示すように配置形状を得、磁化回転抑制層としての反強磁性体PtMn(45)堆積後(図9(d))、その配置も同様のフォトリソグラフィック工程を経て、図9(e)の構造を作成した。最後に電極体Ta(5)/Cu(200)/Ta(50)を図9(f)に示すように配置することにより、素子を完成させた。

【0074】作成した素子に対して外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を評価した。磁界の印可は細線の長手方向に平行に印可した。評価を行った際の細線のサイズは、幅10nm、厚み20nm、長さ250nm程度であった。

【0075】サンプル1を加工した素子において室温で観測された磁気抵抗変化率は約8%であった。

【0076】より顕著に効果を評価するため、低温下(5K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高30%であった。

【0077】ここでは、図9に示した工程により素子加工を実現したが、これに限らずとも同様の構造を有する素子を実現できれば、本発明は所望の効果を発揮するため、これに限らない。

【0078】また、ここでは磁性体としてCoFeを用いたが、Fe、Co、Ni、FeCo合金、NiFe合金、CoNi合金、NiFeCo合金、あるいはFeCr、FeSiAl、FeSi、FeAl、FeCoSi、FeCoAl、FeNiPt、FePd、FeRh、FeIr、FeRu、FePt、FeVにおいても磁気抵抗変化が観測された。

【0079】また伝導体としては、主としてCuを用いたが、Al、Ag、Au、Ptを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0080】また反強磁性体としては、PtMnを用いたが、PtPdMn、FeMn、IrMn、NiMnを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0081】(実施例2) Si/SiO₂基板上に炭素チューブを真空槽内にて所望の位置に配置し、電極形状パターンをレジストにてあらかじめ形成する。この上に、SiO₂層を堆積し、その後リフトオフにて電極形状の反転パターンを形成した。

【0082】次に多元スパッタを用いて以下の要領でサンプルを作製した。

【0083】サンプル2

AuCr(0あるいは0.5)/CoFe(45)/Ta(15)

サンプル3

AuCr(0あるいは0.5)/AlO(0.5)/CoFe(45)/Ta(15)

(単位はnm)

それから基本的な手法としては図9に示したフォトリソグラフィックな方法を用いて、最終的に図1に示すような素子を完成させた。

【0084】ここで、伝導体として単層炭素チューブを用いて、磁性体間が最小部での長さ約250nm、幅・高さは炭素チューブの直径分に当たり、約3nmであった。伝導体上の保護用の絶縁体としてSiO₂(200nm)を用いた。反強磁性体としてはPtMn(60)を、電極体としてはTa(5)/Cu(200)/Ta(50)を用いて素子を完成させた。

【0085】なお、AlO()の()内の値は、酸化処理前のAlの設計膜厚の合計値を示し、実際にはAlを0.3~0.7nm成膜後、酸素含有雰囲気中で酸化することを繰り返して作製した。本実施例では0.5nmのAlを酸化させて作成している。

【0086】作成した素子に対して外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を評価した。磁界の印可は細線の長手方向に平行に印可した。

【0087】サンプル2を加工した素子において、室温で磁気抵抗効果が観測された。

【0088】より顕著に効果を評価するため、低温下(5K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高12%であった(図2参照)。

【0089】またサンプル3を加工した素子においても、磁気抵抗効果が観測された。

【0090】低温下(5K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高22%であった。磁性体と伝導体である炭素チューブとの間に絶縁体を介した場合の方が、効率

よくスピン偏極電子の注入が可能であることを示唆している。

【0091】ここでは、図9に示した工程により素子加工を実現したが、これに限らずとも同様の構造を有する素子が実現できれば、本発明は所望の効果を発揮するため、これに限らない。

【0092】また、ここでは磁性体としてCoFeを用いたが、Fe、Co、Ni、FeCo合金、NiFe合金、CoNi合金、NiFeCo合金、あるいはNiFeCo-シアン錯体、あるいはFeN、FeTiN、FeAlN、FeSiN、FeTa₂N、FeCoN、FeCoTiN、FeCoAlSiN、FeCoTa₂N、あるいはCoFeV、CoFePt、CoFeTa、CoFeBにおいても磁気抵抗変化が観測された。

【0093】伝導体として、ここでは単層炭素チューブを用いたが、多層の炭素チューブを用いても同様の効果が得られるため、これに限らない。この際のチューブの幅は、2nm~30nm程度である。

【0094】また電極体としては、主としてCuを用いたが、Al、Ag、Au、Ptを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0095】また反強磁性体としては、PtMnだけでなく、PtPdMn、FeMn、IrMn、NiMnを用いても、磁気抵抗変化が観測された。

【0096】あるいは反強磁性体の代わりに高保持力磁性体である、CoPt、FePt、CoCrPt、CoTaPt、FeTaPt、FeCrPtを配置しても実質上、磁性電極の一方が高保磁力を有するため、所望の磁気抵抗変化が観測できた。

【0097】(実施例3) Si/SiO₂基板上において、多元スパッタを用いて以下の要領でサンプルを作製した。

【0098】サンプル4

NiO(50)/Ta(5)

(単位はnm)

それから基本的な手法としてはフォトリソグラフィックな方法を用いて、所望のパターンにサンプル4の膜を加工し、その後逆スパッタ法を用いてサンプル4膜上層のTaをスパッタしてから、その上に真空槽内に炭素チューブをサンプル4膜の加工端部の位置に配置し、磁性膜としてAuCr(0あるいは0.5)/AlO(0.5)/CoFe(30nm)/Ta(15)を堆積・加工して、図3(b)の配置の素子を完成させた。このときの斜面の角度を25度から70度とするのが最も適している。この範囲であるとき、最も再現性良く、磁気抵抗素子を作成できた。炭素チューブを用いる場合にも、この範囲にあるとき、炭素チューブの端部での折れ曲がり、その伝導特性が与える影響が少なく好ましい。

【0099】ここで伝導体として単層炭素チューブを用いて、磁性体間が最小部での長さ約250nm、幅・高さは炭素チューブの直径分に当たり、約3nmであった。伝導体上の保護用の絶縁体としてSiO₂(200nm)を用いている。電極体としてはTa(5)/Cu(200)/Ta(50)を用いて素子を完成させた。

【0100】本実施例にて示すように、磁化回転抑制層である反強磁性層にてあらかじめパターン化しておき、その上に伝導体を配置する方が素子を完成させるのが、図1の配置よりも簡便なため好ましい。更に図3(b)の配置の方が伝導体の微細加工を施す上で、また微小位置に配置する上で、図3(a)の配置よりも簡便なため好ましい。

【0101】外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を評価した。

【0102】サンプル4を加工した素子において、室温で磁気抵抗効果が観測された。

【0103】より顕著に効果を評価するため、低温下(5K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高22%であった。

【0104】ここでは、図9に示した工程により素子加工を実現したが、これに限らずとも同様の構造を有する素子が実現できれば、本発明は所望の効果を発揮するため、これに限らない。

【0105】続いて、サンプル4を加工して作成した素子の伝導体である炭素チューブ上に保護用の絶縁体膜SiO₂ (100nm)のかわりに、電界印可用のゲート電極を、別な絶縁体を介して配置した。用いた絶縁体はフタロシアニン膜(5nm)、電極体としてCuフタロシアニン膜(50nm)/Cu(150)/Ta(50)を用いた。

【0106】ゲート電極を用いて、電界印可を-1Vから5Vまで変化させ、その磁気抵抗変化を室温で測定したところ、電界印可がゼロの場合には両磁性層の磁化方向の揃った場合に抵抗が、それ以外に比べて低くなる特性を示している。電界を0から1V印可した場合には磁気抵抗変化は複雑な振る舞いを示し、場合によって、磁化方向の揃った場合に、必ずしも抵抗が低くならなかった。さらに、電界を印可していくと、約5Vで磁気抵抗変化が見られなくなった。これにより、電界印可によって、磁気抵抗特性が制御できる。

【0107】また、ここでは磁性体としてCoFeを用いたが、Fe、Co、Ni、FeCo合金、NiFe合金、CoNi合金、NiFeCo合金を用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0108】また、ゲート部の絶縁体としてフタロシアニンをを用いたが、ここで炭素チューブとフタロシアニンとの両者の相性は極めて良く、接触界面がなめらかに作成できるという長所が確認された。

【0109】また電極体としては、主としてCuを用いたが、Al、Ag、Au、Ptを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0110】また反強磁性体としては、絶縁性のNiOを用いたが、 α -Fe₂O₃、CrO/NiO、RFeO₃ (Rは希土類元素で、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb)を用いても、磁気抵抗変化が観測された。

【0111】(実施例4) 実施例1と同様な手法で、まず、SOI/SiO₂基板を用いて、Siの細線を作成した。

【0112】所望の5-50nmサイズのSiの細線を得た後、PSG(リンケイ酸ガラス)を用いてのリンの熱拡散を800℃で約10分程度行い、細線全体にドーピングして導電性を与えた。この際のキャリア濃度は、10¹⁹/cm³にした。更にSi細線作成後に、細線表面に熱酸化によって2.5nm程度の絶縁酸化膜を作成した。更にSi細線作成後に、細線表面に熱酸化によって1-5nm程度の絶縁酸化膜を作成した。続いて、薄いアモルファスSi層を瞬時熱酸化を行って、径が2-10nm程度のSiドットを細線上に形成した。これにより、単電子チャージングの効果が期待される。この上にTEOS(テトラエトキシラン)膜を20-100nm程度堆積し、更にこの上にゲート電極としてpoy-Siゲートを作成した。作成したゲート幅は0₂アッシングの微細化技術を用いて、10-100nmで作成した。本実施例の典型としては、40nm程度であった。この微細加工部分に通常の有機レジスト体を堆積し、その上に多元スパッタを用いて以下の要領でサンプルを作製した。

【0113】サンプル5

Ta(1)/CoFe(15)/Ta(15)

(カッコ内の単位はnm)

素子の作成は実施例1の際と同様、図9の工程に従って行った。最後に電極体Ta(5)/Cu(200)/Ta(50)を図9

(f)に示すように配置することにより、素子を完成させた。また反強磁性体としてPtMn(50)を用いた。

【0114】作成した素子に対して外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を、ゲート電界印可の下で評価した。磁界の印可は細線の長手方向に平行に印可した。

【0115】ゲート電極を用いて、電界印可を-1Vから5Vまで変化させ、その磁気抵抗変化を室温で測定したところ、電界印可がゼロの場合には両磁性層の磁化方向の揃った場合に抵抗が、それ以外に比べて低くなる特性を示している。電界を0から1V印可した場合には磁気抵抗変化は複雑な振る舞いを示し、場合によって、磁化方向の揃った場合に、必ずしも抵抗が低くならなかった。さらに、電界を印可していくと、約5Vで磁気抵抗変化が見られなくなった。これにより、電界印可によって、磁気抵抗特性が制御できる。

【0116】サンプル5を加工した素子において室温で観測された磁気抵抗変化率は約8%であった。

【0117】より顕著に効果を評価するため、低温下(5K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高30%であった。

【0118】ここでは、図9に示した工程により素子加工を実現したが、これに限らずとも同様の構造を有する素子が実現できれば、本発明は所望の効果を発揮するため、これに限らない。

【0119】また、ここでは磁性体としてCoFeを用いたが、Fe、Co、Ni、FeCo合金、NiFe合金、CoNi合金、NiFeCo合金、あるいはFeCr、FeSiAl、FeSi、FeAl、FeCoSi、

FeCoAl, FeNiPt, FePd, FeRh, FeIr, FeRu, FePt, FeV においても磁気抵抗変化が観測された。

【0120】また伝導体としては、主としてCuを用いたが、Al、Ag、Au、Ptを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0121】また反強磁性体としては、PtMnを用いたが、PtPdMn、FeMn、IrMn、NiMnを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0122】(実施例5) Si/SiO₂ 基板上に炭素チューブを真空溝内にて所望の位置に配置し、電極形状パターンをレジストにてあらかじめ形成する。この上に、SiO₂ 層を堆積し、その後リフトオフにて電極形状の反転パターンを形成した。

【0123】次に多元スパッタを用いて以下の要領でサンプルを作製した。

【0124】サンプル6

AuCr(0あるいは0.5)/AlO(0.5)/CoFe(45)/Ta(15)

(単位はnm)

それから基本的な手法としては図9に示したフォトリソグラフィックな方法を用いて、最終的に図7(d)に示すような素子を完成させた。非磁性絶縁体である熱酸化のSiO₂ ゲート酸化膜は約100-300nmで、ゲート電極としてSi基板を利用した。

【0125】ここで、伝導体として単層炭素チューブを用いて、磁性体間が最小部での長さ約150nm、幅・高さは炭素チューブの直径分に当たり、約3nmであった。伝導体上の保護用の絶縁体としてSiO₂ (200nm)を用いた。反強磁性体としてはPtMn(60)を、電極体としてはTa(5)/Cu(200)/Ta(50)を用いて素子を完成させた。

【0126】なお、AlO()の()内の値は、酸化処理前のAlの設計膜厚の合計値を示し、実際にはAlを0.3~0.7nm成膜後、酸素含有雰囲気中で酸化することを繰り返して作製した。本実施例では0.5nmのAlを酸化させて作成している。

【0127】作成した素子に対して外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を評価した。磁界の印可は細線の長手方向に平行に印可した。

【0128】サンプル6を加工した素子において、室温で磁気抵抗効果が観測された。

【0129】低温下(5K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高20%であった。作成した素子に対して外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を、ゲート電界印可の下で評価した。磁界の印可は細線の長手方向に平行に印可した。

【0130】ゲート電極を用いて、電界印可を-1Vから5Vまで変化させ、その磁気抵抗変化を室温で測定したところ、電界印可がゼロの場合には両磁性層の磁化方向の揃った場合に抵抗が、それ以外に比べて低くなる特性を示している。電界を0から1V印可した場合には磁気抵抗変化は複雑な振る舞いを示し、場合によって、磁化

方向の揃った場合に、必ずしも抵抗が低くならなかった。さらに、電界を印可していくと、約5Vで磁気抵抗変化が見られなくなった。これにより、電界印可によって、磁気抵抗特性が制御できる。

【0131】また、ここでは磁性体としてCoFeを用いたが、Fe、Co、Ni、FeCo合金、NiFe合金、CoNi合金、NiFeCo合金、あるいはNiFeCo-シアン錯体、あるいはFeN、FeTiN、FeAlN、FeSiN、FeTa₂N、FeCoN、FeCoTiN、FeCoAlSiN、FeCoTa₂N、あるいはCoFeV、CoFePt、CoFeTa、CoFeBにおいても磁気抵抗変化が観測された。

【0132】伝導体として、ここでは単層炭素チューブを用いたが、多層の炭素チューブを用いても同様の効果が得られるため、これに限らない。この際のチューブの幅は、2nm-30nm程度である。

【0133】また電極体としては、主としてCuを用いたが、Al、Ag、Au、Ptを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0134】また反強磁性体としては、PtMnだけでなく、PtPdMn、FeMn、IrMn、NiMnを用いても、磁気抵抗変化が観測された。

【0135】あるいは反強磁性体の代わりに高保持力磁性体である、CoPt、FePt、CoCrPt、CoTaPt、FeTaPt、FeCrPtを配置しても実質上、磁性電極の一方が高保磁力を有するため、所望の磁気抵抗変化が観測できた。

【0136】(実施例6) GaAs(001)基板上に多元分子線エピタキシー手法を用いて以下の要領でサンプルを作製した。

【0137】サンプル7

GaAs(100)/MnAs(15)

サンプル8

GaAs(100)/MnAs(50)

(単位はnm)

本サンプルでは、GaAs基板に対して、約600℃にてAsフラックス照射による雰囲気下にて基板を清浄化させ、その上にGaAs層をバッファ層として約600℃の高温中にて堆積させ、一旦200~250℃のもとで、わずかのMnフラックス照射の後にMnAs層を堆積させた。堆積したMnAsは(-1101)面を成長面としている。また堆積させた膜の磁化測定から、両サンプルは共に磁化容易軸は(-110)GaAs方位を有していることが確認された。

【0138】このサンプルに図9に示すようなフォトリソグラフィックな手法を用い、マスク材としてポジレジストを所望のパターン形状にて形成し、アルゴンイオン照射によるドライエッチングを用いて、レジストパターン形状になるよう磁性体であるサンプル7、8の薄膜に加工を施す。さらにその上に伝導体を堆積し、リフトオフにより、所望の形状を得る。またここで場合により伝導体をバリスティック伝導を司る形状にすることが必要な場合には、さらにここで説明をしたようなフォトリソグラフィックの手法を用いて、形状加工を行う。ま

た、電子ビームや収束型イオンビーム、走査型トンネル電流観測装置付随の短針などの微細加工に適した関連装置を用いて直接形状加工を行ってももちろん構わないことも確認した。さらに場合によってパシベーションが必要な場合には伝導体上に絶縁膜を堆積する。

【0139】ここで、用いた伝導体はAu (10nm) 膜で、マスク材としてポジレジストを、露光には電子露光技術を用いた。伝導体は磁性電極間が最小部での長さ約80nm、幅は最小部が約10nmにて加工を行った。絶縁膜はSiO₂ (100nm)を用いた。

【0140】次に、サンプル7およびサンプル8ともに、反強磁性体としてPtMn(60)を堆積・加工を施し、電極体として、Ta(5)/Pt(200)/Ta(50)を堆積・加工を施し、図9(f)の構造を実現した。

【0141】外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を評価した。

【0142】サンプル7およびサンプル8を加工した素子において、磁気抵抗効果が観測された。

【0143】より顕著に効果を評価するため、室温下(300K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率はサンプル5において、最高10%、サンプル6において最高11%であった。さらに低温下(5K)においては、磁気抵抗変化率はサンプル7において最高18%、サンプル8において最高20%であった。

【0144】さらに、サンプル8の構成にて、伝導体として単層炭素チューブを用い、磁性体間が最小部での長さ約250nm、幅・高さが約20nmにて同様の図9(f)の構成を実現し、電気特性の評価を行った。

【0145】本素子においても、磁気抵抗効果が観測された。

【0146】室温下(300K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高13%、さらに低温下(5K)においては、磁気抵抗変化率は最高22%であった。

【0147】ここでは、図9に示した工程により素子加工を実現したが、これに限らずとも同様の構造を有する素子が実現できれば、本発明は所望の効果を発揮するため、これに限らない。

【0148】また、ここでは磁性体としてマンガングアニクタイトド(Mn-V族元素)であるMnAsを用いたが、同種のMnSb、あるいはQDA(QはSc, Y, ランタノイド, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Znから選ばれた少なくとも1種、AlはC, N, O, F, Sから選ばれた少なくとも1種、Dは、V, Cr, Mn, Fe, Co, Niから選ばれた少なくとも1種)、あるいはGaMnN, AlMnN, GaAlMnN, AlBMnN等のRDA(Rは、B, Al, Ga, Inから選ばれた1種、Dは、V, Cr, Mn, Fe, Co, Niから選ばれた1種、AlはAs, C, N, O, P, Sから選ばれた1種)等に代表されるものを用いても磁気抵抗変化が確認されている。

【0149】また伝導体としては、主としてCuを用いたが、Al, Ag, Ptを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0150】また反強磁性体としては、PtMnを用いたが、PtPdMn, FeMn, IrMn, NiMnを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0151】(実施例7) GaAs(001)方位基板上に多元分子線エビタクシー手法を用いて以下の要領でサンプルを作製した。

【0152】サンプル9

GaAs(100)/MnAs(15)

サンプル10

GaAs(100)/MnAs(50)

(単位はnm)

本サンプルでは、GaAs基板を約600℃にてAsフラックス照射による雰囲気中にて基板を清浄化させ、その上にGaAs層をバッファ層として約600℃の高温中にて堆積させ、さらに200~250℃にてAsフラックスを少量照射し、その後As照射に加えてMnを照射していくことでMnAs層を堆積させた。堆積したMnAsは(-110)面を成長面としている。堆積させた膜の磁化測定から、両サンプルはともに、磁化容易軸は[110]GaAs方位を有していることが確認された。

【0153】このサンプルのうちサンプル9に実施例5に示したのと同様の工程によって、図9(f)の構造を実現した。

【0154】用いた伝導体はAu (10nm) 膜で、マスク材としてポジレジストを、露光には電子露光技術を用いた。伝導体は磁性電極間が最小部での長さ約80nm、幅は最小部が約10nmにて加工を行った。絶縁膜はSiO₂ (100nm)を用いた。反強磁性体としてPtMn(60)を、電極体としてTa(5)/Pt(200)/Ta(50)を用いた。

【0155】外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を評価した。

【0156】サンプル7を加工した素子において、磁気抵抗効果が観測された。

【0157】より顕著に効果を評価するため、室温下(300K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高13%、さらに低温下(5K)においては、磁気抵抗変化率は最高25%であった。

【0158】一方で、サンプル10は磁化測定の結果から、主として反強磁性体であることが分かった。そこで、サンプル8の膜を所望の形状にフォトリソグラフィックな手法を用いて加工し、その上に磁性体としてCoFeを堆積・加工し、伝導体としてAu (10nm) 膜を用い、マスク材としてはポジレジストを、露光には電子露光技術を用いて、伝導体の長さ約80nm、幅は最小部が約10nmにて加工を行った。その上に絶縁膜SiO₂ (100nm)を堆積した。電極体としてTa(5)/Pt(200)/Ta(50)を用いて、図3(b)の構成を実現した。

【0159】ここでも外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を評価した。

【0160】サンプル10を加工した素子において、磁

気抵抗効果が観測された。

【0161】室温下(300K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高16%、さらに低温下(5K)においては、磁気抵抗変化率は最高28%であった。

【0162】さらに、サンプル10の構成にて、伝導体として単層炭素チューブを用い、磁性体間が最小部での長さ約250nm、幅・高さが約20nmにて図3(b)の構成を実現し、電気特性の評価を行った。

【0163】磁性体としてCoFeを、電極体としてはTa(5)/Pt(200)/Ta(50)を用いた。

【0164】本素子においても、磁気抵抗効果が観測された。

【0165】室温下(300K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高18%、さらに低温下(5K)においては、磁気抵抗変化率は最高38%であった。

【0166】また、ここではサンプル9の磁性体としてMnAsを用いたが、同種のMnSb、あるいはQDA(QはSc, Y, ランタノイド, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Znから選ばれた少なくとも1種、AlはC, N, O, F, Sから選ばれた少なくとも1種、Dは、V, Cr, Mn, Fe, Co, Niから選ばれた少なくとも1種)、あるいはGaMnN, AlMnN, GaAlMnN, AlB MnN等のRDA(Rは、B, Al, Ga, Inから選ばれた1種、Dは、V, Cr, Mn, Fe, Co, Niから選ばれた1種、AlはAs, C, N, O, P, Sから選ばれた1種)等に代表されるものを用いても磁気抵抗変化が確認される。

【0167】また、サンプル10のように成膜条件により反強磁性を示すものとしてMnAsを用いたが、これは構造的な歪み・圧力が磁性特性の変化に大きく作用しているものと思われる。よって、歪み・圧力誘起あるいはキャリア注入によって引き起こされる反強磁性を有する物質を、磁化回転抑制層として用いても本発明は実現できることが確認された。

【0168】また、サンプル10において磁性体としてCoFeを用いたが、Fe, Co, Ni, FeCo合金, NiFe合金, CoNi合金, NiFeCo合金を用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0169】また伝導体としては、主としてPtを用いたが、Al, Ag, Cuを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0170】また反強磁性体としては、PtMnを用いたが、PtPdMn, FeMn, IrMn, NiMnを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0171】(実施例8) GaAs(001)方位基板上に多元分子線エビタクシー手法を用いて以下の要領でサンプルを作製した。実施例7にて示すように、サンプル10の構成にて、伝導体として単層炭素チューブを用い、図3(b)の構成した実施例7に示した磁気抵抗素子において、図10の様に伝導体の一部に電界印可用のゲート電極を、絶縁体を介して配置した(本構成は図7(a)の構成に準じる)。本実施例でのd、Dの典型的な値は30nm、250nmである。

【0172】室温下(300K)にて行ったところ、ゲート電界ゼロの状態では磁気抵抗変化率は最高18%、ゲート電界印可により図11のような電界効果を示し、磁気抵抗変化もゲート電圧6Vにてゼロになった。

【0173】また、ここではサンプル7の磁性体としてMnAsを用いたが、同種のMnSb、あるいはQDA(QはSc, Y, ランタノイド, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Znから選ばれた少なくとも1種、AlはC, N, O, F, Sから選ばれた少なくとも1種、Dは、V, Cr, Mn, Fe, Co, Niから選ばれた少なくとも1種)、あるいはGaMnN, AlMnN, GaAlMnN, AlB MnN等のRDA(Rは、B, Al, Ga, Inから選ばれた1種、Dは、V, Cr, Mn, Fe, Co, Niから選ばれた1種、AlはAs, C, N, O, P, Sから選ばれた1種)等に代表されるものを用いても磁気抵抗変化が確認される。

【0174】また、実施例7に示したように成膜条件により反強磁性を示すものとしてMnAsを用いたが、これは構造的な歪み・圧力が磁性特性の変化に大きく作用しているものと思われる。よって、歪み・圧力誘起あるいはキャリア注入によって引き起こされる反強磁性を有する物質を、磁化回転抑制層として用いても本発明は実現できることが確認された。

【0175】また、サンプル10において磁性体としてCoFeを用いたが、Fe, Co, Ni, FeCo合金, NiFe合金, CoNi合金, NiFeCo合金を用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0176】また伝導体としては、主としてPtを用いたが、Al, Ag, Cuを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0177】また反強磁性体としては、PtMnを用いたが、PtPdMn, FeMn, IrMn, NiMnを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0178】(実施例9) GaAs(001)基板上に対してイオン注入手法を用いることにより、MnイオンのGaAs基板中注入領域を作成した。Mnイオンはスパッタにて発生させた。スパッタで生じたMnイオンをイオン加速部に引き込み、さらに加速電圧100keV程度にて、GaAs基板表面から約50nmまでの深さ領域に注入を施した。注入キャリアはおおよそ $4 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 程度で、 $(\text{Ga}_{1-x}\text{Mn}_x)\text{As}$ として換算したx量として約5.5%程度であると思われる。磁化測定から見積もられるキュリー温度は約100Kであった。

【0179】このような強磁性を形成した基体上に、炭素チューブを真空槽内にて所望の位置に配置し、その後、一方の注入領域上にPtMn(50nm)を堆積・加工して、図4(b)の構成を持つ素子を作成した。

【0180】伝導体である炭素チューブ上に絶縁膜SiO₂(100nm)を、また電極体としてはTa(5)/Pt(200)/Ta(50)を用いた。

【0181】外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を評価した。

【0182】低温下(5K)にて測定を行ったところ、

磁気抵抗変化率は最高10%であった。

【0183】続いて、作成した本実施例のサンプルを加工して作成した素子の伝導体である炭素チューブ上に保護用の絶縁体膜 SiO_2 (100nm)のかわりに、電界印可用のゲート電極を、絶縁体を介して配置した。用いた絶縁体はフタロシアニン膜(50nm)、電極体としてTa(5)/Cu(200)/Ta(50)を用いた。

【0184】ゲート電極を用いて、電界印可を-1Vから5Vまで変化させ、その磁気抵抗変化を測定したところ、電界印可がゼロの場合には両磁性層の磁化方向の揃った場合に抵抗が、それ以外に比べて低くなる特性を示している。電界を0から1V印可した場合には磁気抵抗変化は複雑な振る舞いを示し、場合によって、磁化方向の揃った場合に、必ずしも抵抗が低くならなかった。さらに、電界を印可していくと、約5Vで磁気抵抗変化が見られなくなった。これにより、電界印可によって、磁気抵抗特性が制御できる。

【0185】また、ここでは磁性体として(Ga,Mn)Asを用いたが、ZnDOあるいはAlDNなどのQDA (QはSc, Y, ランタノイド, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Znから選ばれた少なくとも1種、AlはC, N, O, F, Sから選ばれた少なくとも1種、DはV, Cr, Mn, Fe, Co, Niから選ばれた少なくとも1種)、あるいはGaMnN, AlMnN, GaAlMnN, AlBMnN等のRDA (RはB, Al, Ga, Inから選ばれた1種、DはV, Cr, Mn, Fe, Co, Niから選ばれた1種、AlはAs, C, N, O, P, Sから選ばれた1種)等に代表されるものを用いても磁気抵抗変化が確認されている。

【0186】また伝導体としては、主としてCuを用いたが、Al, Ag, Au, Ptを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0187】また反強磁性体としては、PtMnを用いたが、PtPdMn, FeMn, IrMn, NiMnを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0188】(実施例10)アセチレンガスを用いて電気化学的にエッチングして作成した多孔性のSi基板上に、Fe(50)を電子ビーム蒸着にてパターンニングしたい所望の場所に作りこんだ。このFe膜は炭素チューブ配向膜の触媒として働く。主としてメタンガスによる炭素供給を行い、CVD法を用いて作成した炭素チューブは、Fe膜状に長手方向が膜面に対して立つように配向している。また、配向した炭素チューブの先端には、触媒のFeが付着していることが分かった。電子ビーム蒸着およびスパッタによりこの上にCoFe(50)/PtMn(50)/Ta(15)/Au(200)を堆積させ、炭素チューブを用いた積層型素子を作成した。

【0189】外部から磁界を印可し、電極体間の電気特性を評価した。

【0190】加工した素子において、室温で磁気抵抗効果が観測された。

【0191】より顕著に効果を評価するため、低温下

(5K)にて行ったところ、磁気抵抗変化率は最高9%であった。

【0192】また、ここでは磁性体としてFeおよびFeCoを用いたが、Ni, Co、またはNiCoFe合金を用いても、触媒作用があるとともに磁気抵抗変化が確認されている。

【0193】また反強磁性体としては、PtMnを用いたが、PtPdMn, FeMn, IrMn, NiMnを用いても磁気抵抗変化が観測された。

【0194】あるいは反強磁性体の替わりに高保持力磁性体である、CoPt, FePt, CoCrPt, CoTaPt, FeTaPt, FeCrPtを配置しても実質上、磁性電極の一方が高保磁力を有するため、所望の磁気抵抗変化が観測できた。

【0195】(実施例11)CMOS基板上に、図12に示すような基本構成のメモリ素子で集積メモリを作製した。素子配列は、 16×16 素子のメモリを1ブロックとし合計8ブロックとした。ここで、素子には、図13の(b)構成で、

サンプル11

Ta(1)/CoFe(15)/Ta(15)

を用いた。

【0196】サンプルの素子断面積は $0.2\mu\text{m} \times 0.3\mu\text{m}$ で、自由磁性層はNiFe(2)とし、形状は図23(a)としている。

【0197】また、ワード線およびビット線などは全てCuを用いた。

【0198】ワード線とビット線の合成磁界により、8つのブロックの、8素子にそれぞれの自由磁性層の磁化反転を同時に行い、8ビットずつの信号を記録した。次に、CMOSで作製されたFETのゲートをそれぞれのブロックに付き1素子ずつONし、センス電流を流した。このとき、各ブロック内でのビット線、素子、及びFETに発生する電圧と、ダミー電圧をコンパレータにより比較し、それぞれの素子の出力電圧から、同時に8ビットの情報を読みとった。

【0199】この際の自由磁性層の長軸と短軸の比は1.5:1(長軸は $0.2\mu\text{m}$)とし、形状を図23(a)~(e)に変えた集積メモリを作製した。これらのメモリの記録に要する消費電力は、図23の(b)~(e)の形状では図23(a)の形状の約3/5~1/2程度であった。

【0200】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、2つの磁性体が少なくとも1つの伝導体を介して接しており、2つの磁性体のうち、一方のみがを磁化回転抑制層が接し、且つ前記伝導体を挟む2つの磁性体の磁化相対角の変化により抵抗が変化することを特徴とする磁気抵抗素子を構成することにより、前記磁化回転抑制層に接していない磁性体を自由磁性体として情報を記録し読み出す磁気メモリや、磁気抵抗効果部の抵抗変化を利用した様々な磁気デバイスとして利用することができる。このため、従来の情報通信端末などに使用される光磁気

ディスク、ハードディスク、デジタルデータストリーマ（DDS）、デジタルVTR等の磁気記録装置の再生ヘッド、またシリンドラや、自動車などの回転速度検出用の磁気センサー、磁気メモリ（MRAM）、応力変化、加速度変化などを検知する応力または加速度センサーあるいは熱センサーや化学反応センサー等の特性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の磁気抵抗素子の構成図
- 【図2】本発明の磁気抵抗素子の動作説明図
- 【図3】本発明の磁気抵抗素子の構成図
- 【図4】本発明の磁気抵抗素子の構成図
- 【図5】本発明の磁気抵抗三端子素子の構成図
- 【図6】本発明の磁気抵抗三端子素子の動作説明図
- 【図7】本発明の磁気抵抗三端子素子の構成図
- 【図8】本発明の磁気抵抗素子の構成図
- 【図9】本発明の磁気抵抗素子の作成工程概略図
- 【図10】本発明の磁気抵抗素子の上面配置図
- 【図11】本発明の磁気抵抗素子の電流電圧特性図

【図12】本発明の磁気メモリの構成概略図

【図13】本発明の磁気メモリの磁気抵抗素子を含む構成概略図

【図14】本発明の磁気メモリの磁気抵抗素子を含む構成概略図

【図15】本発明の磁気メモリの磁気抵抗素子を含む動作説明図

【図16】本発明の磁気メモリの磁気抵抗素子を含む動作説明図

【図17】本発明の磁気メモリの磁気抵抗素子を含む構成概略図

【図18】本発明の磁気メモリの構成概略図

【図19】本発明の磁気メモリの出力検出動作説明図

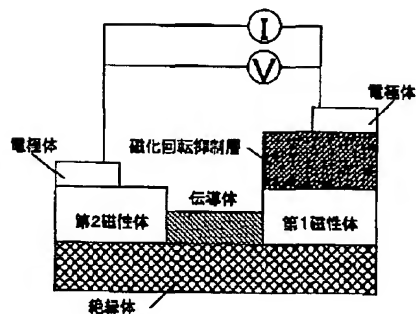
【図20】本発明の磁気メモリの構成概略図

【図21】本発明の磁気抵抗素子の動作説明図

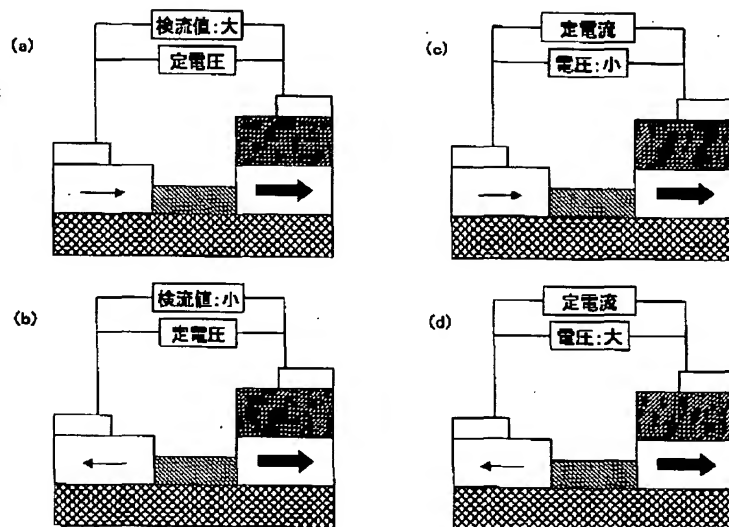
【図22】本発明の磁気抵抗素子のMR特性を示す図

【図23】本発明の磁気抵抗素子の自由磁性層の面内形状図

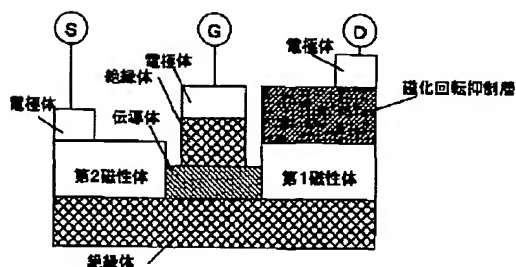
【図1】



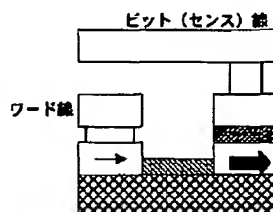
【図2】



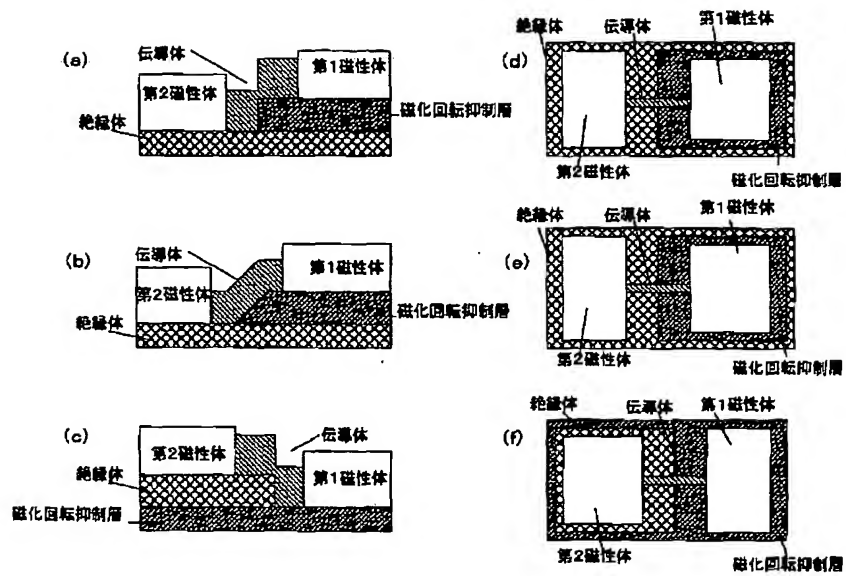
【図5】



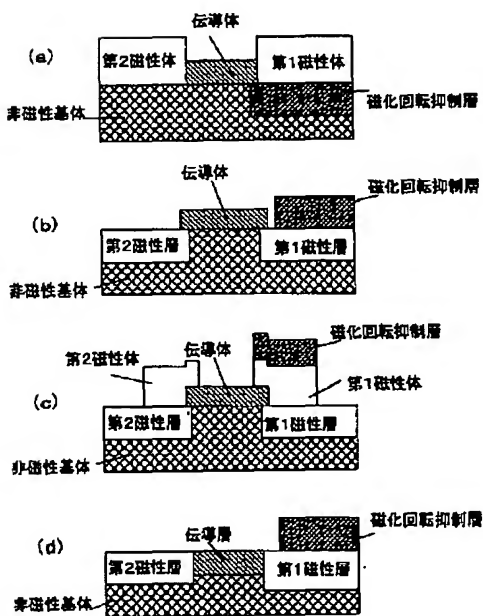
【図14】



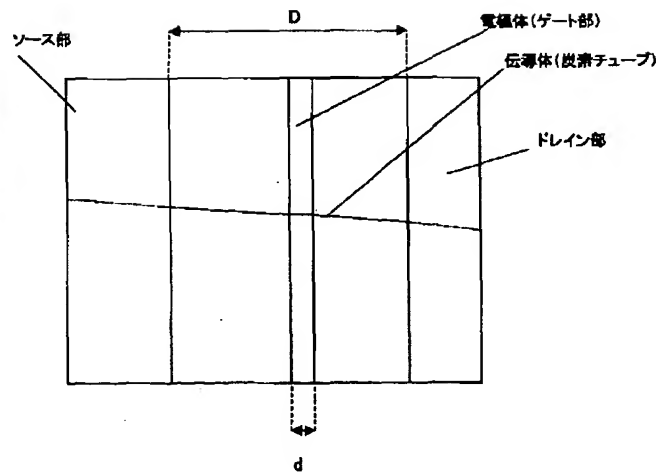
【図3】



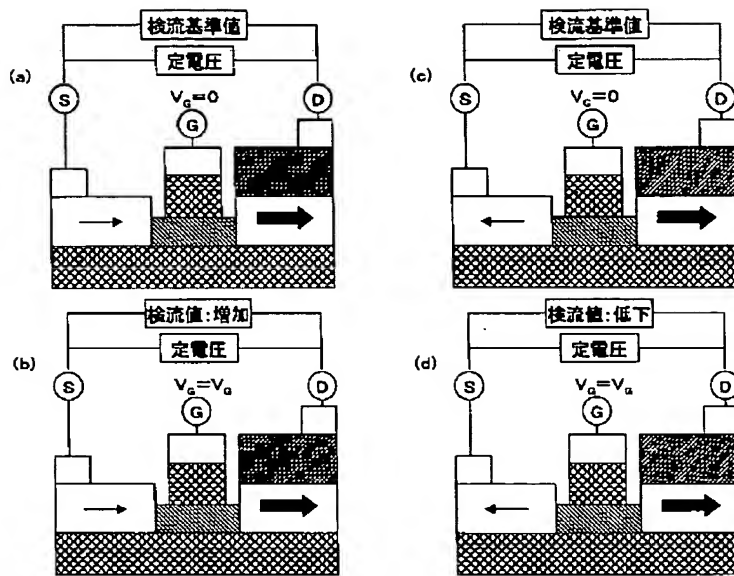
【図4】



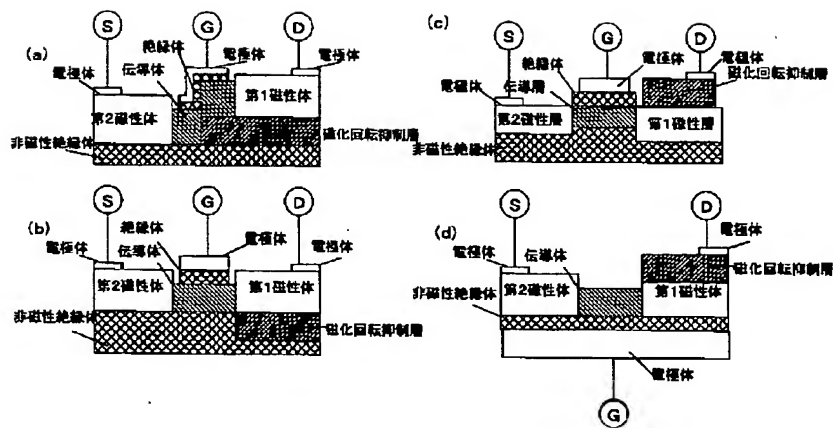
【図10】



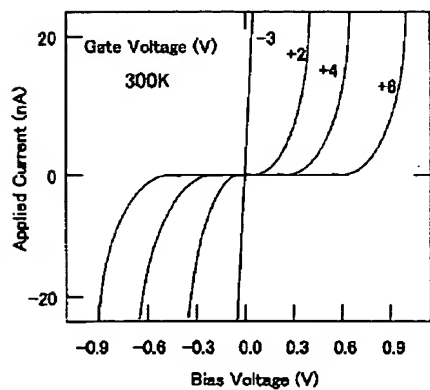
【図6】



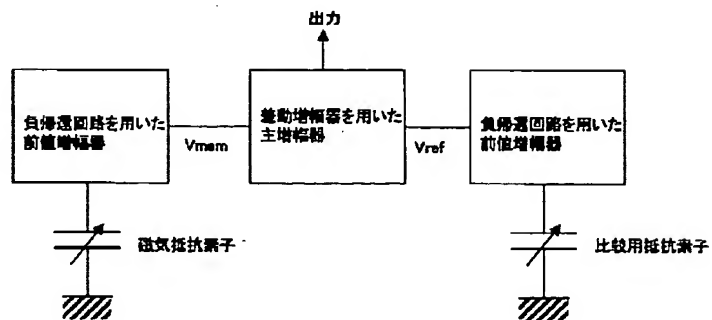
【図7】



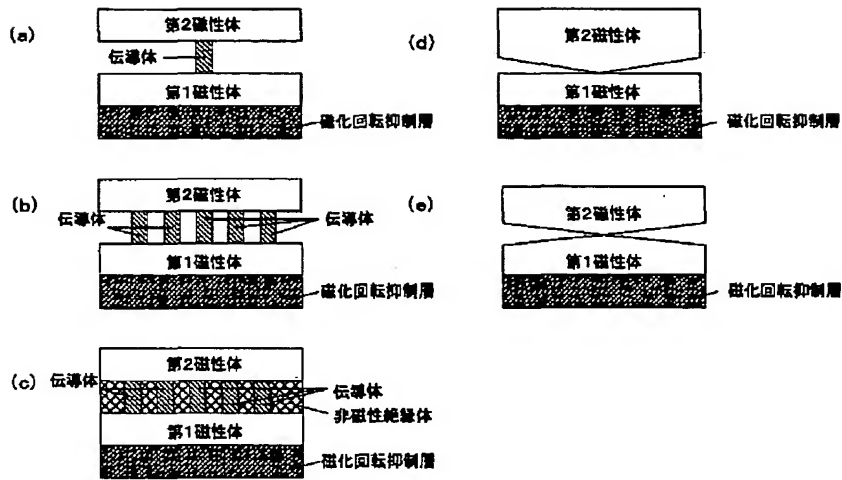
【図11】



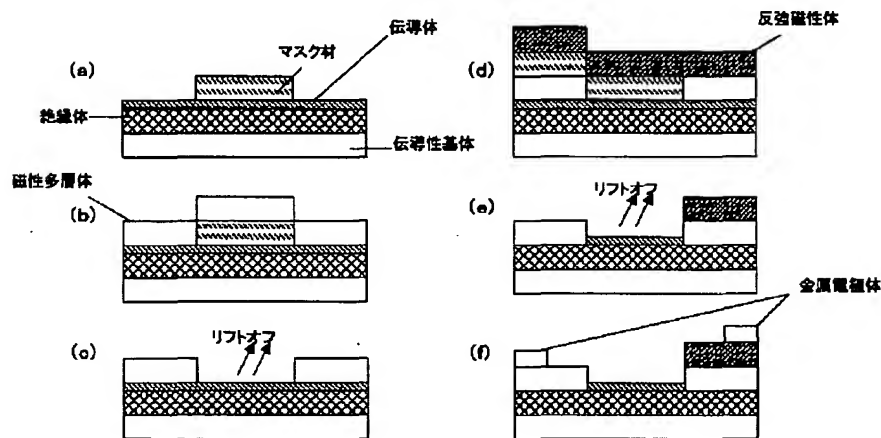
【図19】



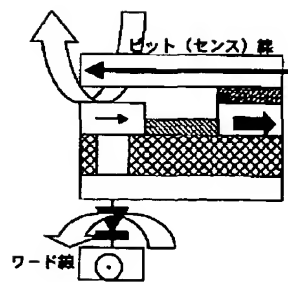
【図8】



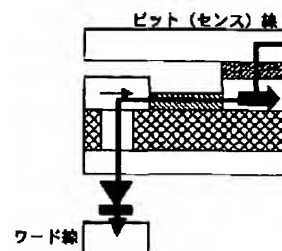
【図9】



【図16】

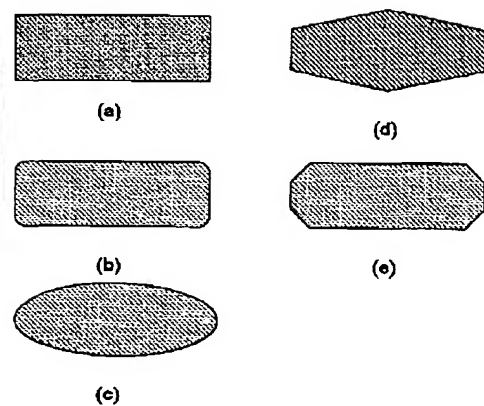


(a) 書き込み時

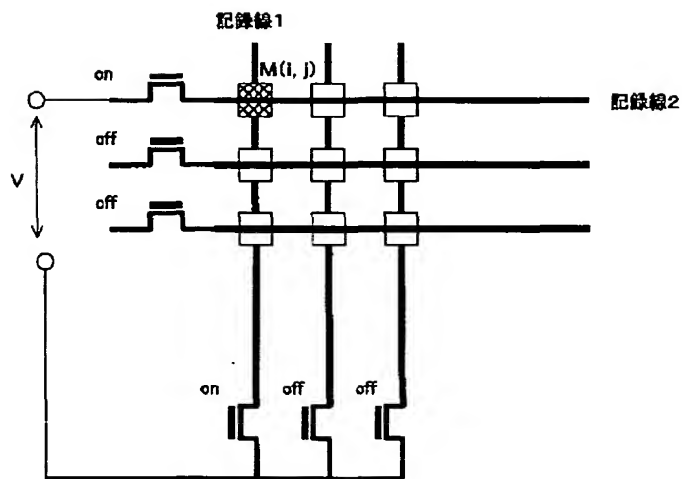


(b) 読み込み時

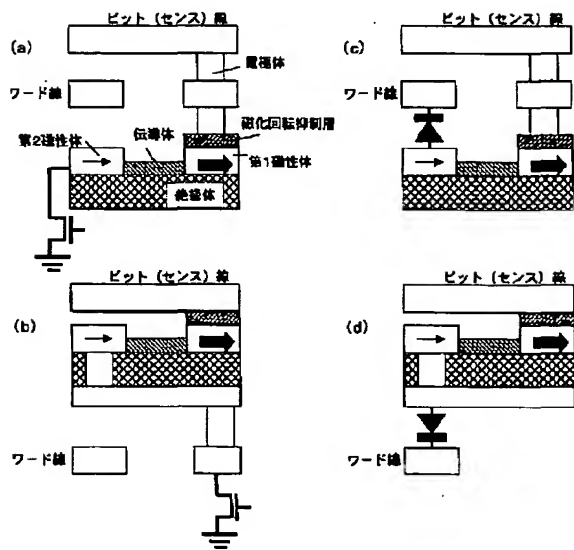
【図23】



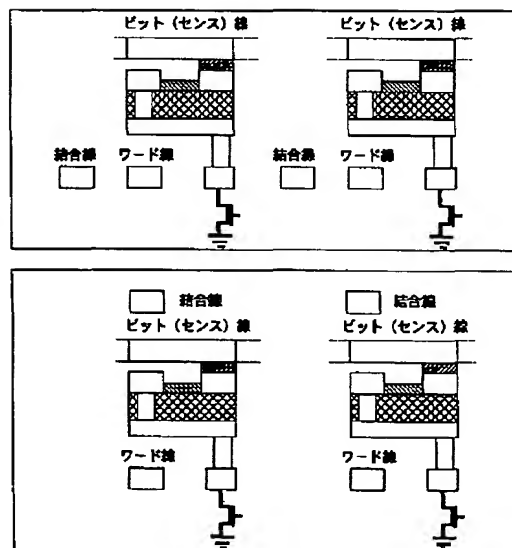
【図12】



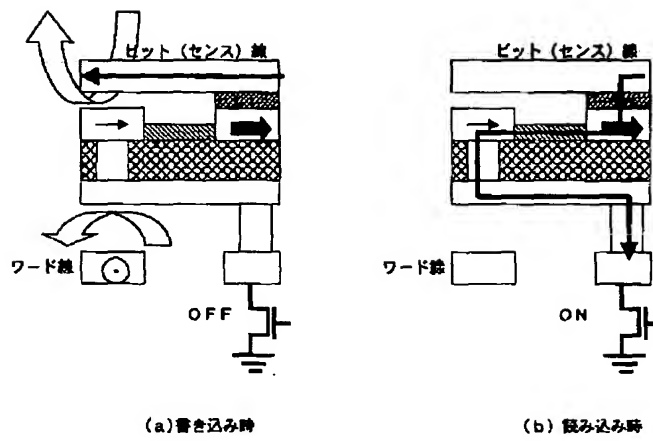
【図13】



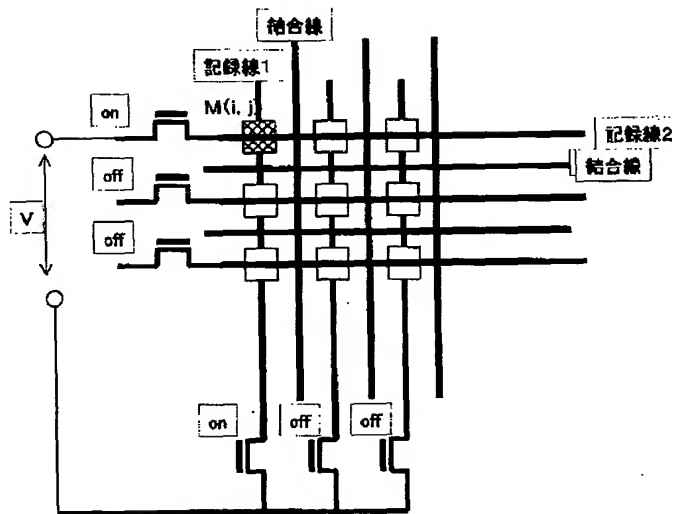
【図17】



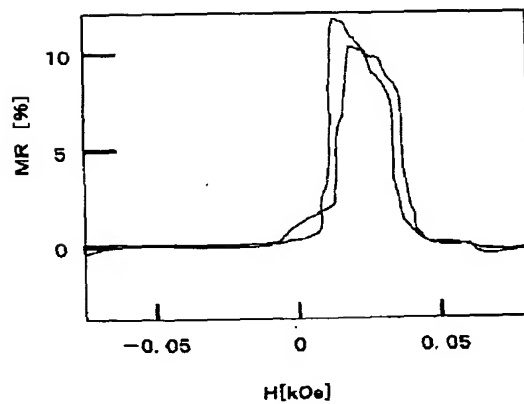
【図15】



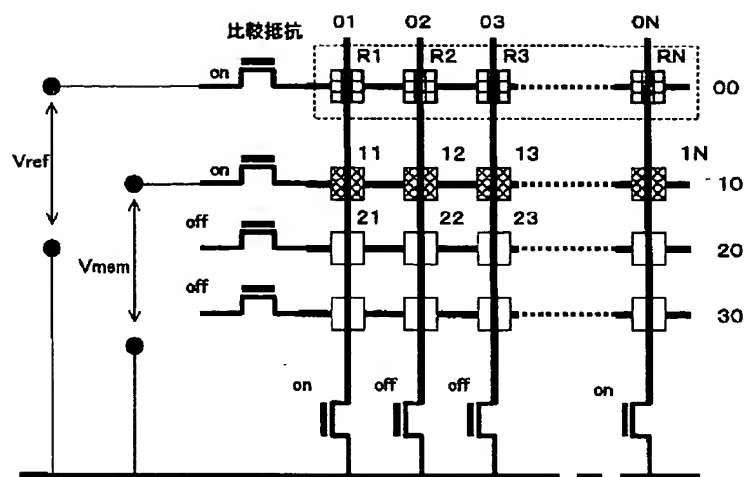
【図18】



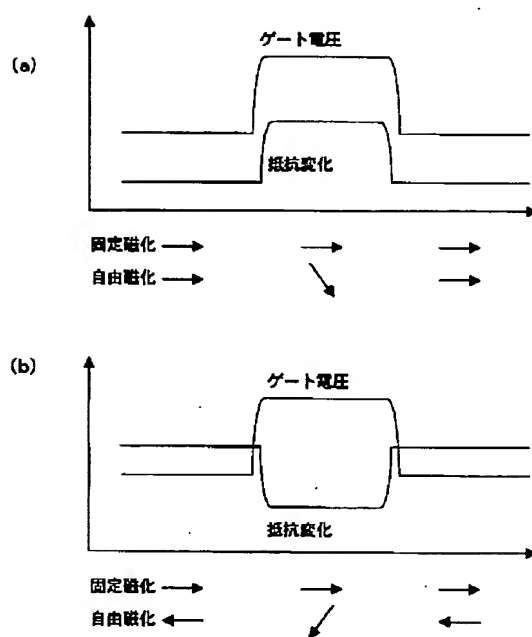
【図22】



【図20】



【図21】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷
H01F 10/32
H01L 27/105

識別記号

FI
H01L 27/10
G01R 33/06

テームド(参考)

447
R

(21) 特開2003-8105 (P2003-8105V5

(72)発明者 杉田 康成
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

F ターム(参考) 2G017 AD55 AD56 AD62 AD63 AD65
5D034 BA03 BA04 BA05 BA15 BB14
CA08
5E049 AA04 AC00 AC05 BA23
5F083 FZ10 GA09 GA30 JA36 JA37
JA38 JA39 JA40 JA56 JA58
JA60 PR03 PR22 PR40

Machine Translation of JP 2003-8105

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001] [The technical field to which invention belongs] The magneto-optic disk, hard disk by which this invention is used for an information communication terminal etc., The reproducing head of magnetic recording media, such as a digital data streamer tape drive (DDS) and digital VTR The magnetic-reluctance sensor represented by the stress, acceleration sensor or heat which detects the angular-velocity magnetic sensor for rotational-speed detection, stress change, acceleration change, etc., the heat sensor using change of the magnetoresistance effect by the chemical reaction, and the chemical reaction sensor, They are the magnetic solid-state memory represented in magnetic random access memory (MRAM), recon figure skating bull memory, etc. or a current switch (magnetic switch) element by the MAG, and the thing with which a voltage switching device etc. is related further. [0002] [Description of the Prior Art] The memory using magnetism can realize memory [**** / un-], because stores as memory the information on the spin which the magnetic substance has, and it is considered to be one of the devices excellent in realization of a future power saving and high-speed information terminal. The artificial grid film which consists of the magnetic film which carried out switched connection through the nonmagnetic membrane until now It is discovered that the huge magnetoresistance effect (GMR) is shown (M.N.Baibich et.al., Phys.Rev.Lett.61 (1988) 2472.). The proposal of MRAM using the GMR film was also made (K.T.M.Ranmuthu et.al., IEEE Trans.on Magn.29 (1993) 2593.). the non-magnetic layer of the aforementioned GMR film -- conductors, such as Cu, -- although it is a film, the research of a tunneled type GMR film (TMR) which used the insulator layer of aluminum₂O₃ grade for the non-magnetic layer also prospers, and MRAM using this TMR film is also proposed Realization of an output with bigger MRAM using the TMR film than the thing of a GMR film and high-density memory is expected. In connection with it, the possibility of an alternative of high-density memory, such as DRAM, is also beginning to be examined, and it waits for establishment of the architecture in the 10 nanometer size of numbers from several future nano which overly aimed at high-density memory. When it becomes a size field so that quantum influence may appear in conduction strongly like the 10 nanometer size of numbers from several nano, the element architecture which draws a line is needed with the former. It is hoped that the memory using magnetism may be able to propose the new element and the new circuit of transmitting spin information directly or controlling transmission spin directly since the information on the spin which is a quantum is stored as memory. [0003] [Problem(s) to be Solved by the Invention] In order to transmit the information on spin directly until now, allotting an ultra-thin tunnel barrier between the magnetic substance like the conventional TMR element, and using a polarization spin tunnel phenomenon can only be realized. Now, a new circuit which controls transmission spin directly cannot be formed. [0004] To this technical problem, this invention lengthens the transmission path of spin and aims at offering the magnetic resistance element realized by providing a transmission path with the desirable material and desirable arrangement using the conductor which enables conduction like a barricade stick, and its example of device composition. [0005] [Means for Solving the Problem] In order to solve the aforementioned technical problem, this invention The inside of at least two magnetic substance, The 1st magnetic substance with which the magnetization rotation suppression layer touched, and the 2nd magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer have touched through at least one conductor. And it is the magnetic resistance element characterized by resistance changing with change of the magnetization relative angle of the two magnetic substance which sandwiches the aforementioned conductor. It can use as various magnetic devices, such as magnetic memory which records and reads information, and a recon figure skating bull circuit using resistance change of the magnetoresistance-effect section, by using as the free magnetic substance the magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer. [0006] Moreover, as this invention sandwiches the 1st magnetic substance, the aforementioned magnetization rotation suppression layer, and insulator with which the magnetization rotation suppression layer touched between at least two magnetic substance, it is allotted. And the 2nd magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer has touched through at least one conductor. And it is the magnetic resistance element by which it is characterized [which is characterized by resistance changing with change of the magnetization relative angle of the two magnetic substance which sandwiches the aforementioned conductor]. It can use as various magnetic devices, such as magnetic memory which records and reads information, and a recon figure skating bull circuit using resistance change of the magnetoresistance-effect section, by using as the free magnetic substance the magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer. [0007] Moreover, the 2nd magnetic substance with which this invention is not in contact with the 1st magnetic substance and the aforementioned magnetization rotation suppression layer which the magnetization rotation suppression layer touched between at least two magnetic substance has touched through at least one conductor. It is the magnetic resistance element characterized by the electric resistance between the two magnetic substance into which at least one of the aforementioned conductors inserts the aforementioned conductor by pouring or induction of an electron or a hole changing. It can use as various magnetic devices, such as magnetic memory which records and reads information, and a recon figure skating bull

circuit using resistance change of the magnetoresistance-effect section, by using as the free magnetic substance the magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer. [0008] It is desirable that a magnetization rotation suppression layer consists of at least one chosen from the antiferromagnetic substance, the laminating ferrimagnetic substance, or the high holding power magnetic substance about this invention. [0009] Moreover, it is desirable to use a carbon tube as a conductor in one operation form. [0010] Moreover, it is desirable to use Si thin line as a conductor in one operation form. [0011] Moreover, as for this invention, the 1st magnetic substance with which the magnetization rotation suppression layer touched between at least two magnetic substance, and the 2nd magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer constitute the layered product through at least one conductor. And it is the magnetic resistance element characterized by resistance changing with change of the magnetization relative angle of the two magnetic substance which sandwiches the aforementioned conductor. It can use as various magnetic devices, such as magnetic memory which records and reads information, and a recon figure skating bull circuit using resistance change of the magnetoresistance-effect section, by using as the free magnetic substance the magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer. [0012] It is desirable to use a carbon tube as a conductor in one operation form also here. [0013] Furthermore, this invention operates as magnetic memory equipped with two or more magnetic resistance elements, meanses of the magnetic field seal of approval to the 2nd magnetic substance of the above, and meanses read the magnetization direction of the 2nd magnetic substance of the above, respectively, and is arranged on the solid state switch element accumulated on the semiconductor substrate, and magnetic memory which is connected to the solid state switch element section at least at the time of the readout of the magnetic memory using the magnetic resistance element of this invention or writing, and operates can be realized. [0014] [Embodiments of the Invention] The magnetic resistance element of this invention is explained using drawing. [0015] First, drawing 1 consists of a magnetization rotation suppression layer, the 1st magnetic layer, the 2nd magnetic layer, and a conduction layer. A conduction layer here is prepared as a conduction layer in which a spin polarization electron can mainly conduct in barricade stick, without seldom receiving dispersion. The 2nd magnetic layer with which the 1st magnetic layer which touched the magnetization rotation suppression layer is not in contact as the fixed bed constitutes the magnetic resistance element as a free layer. In case resistance of an element is detected, it carries out to the 1st magnetic layer and the 2nd magnetic layer by arranging an electrode object. When a magnetization rotation suppression layer is also a conductor like drawing 1, you may arrange an electrode object on a magnetization rotation suppression layer. [0016] The 1st magnetic layer is touching a magnetization rotation suppression layer, and it is desirable to join together magnetically and to make magnetization rotation difficult. As for the magnetization quick wit suppression layer in this case, it is desirable that it is the multilayer of the high holding power magnetic substance, the laminating ferrimagnetic substance, the antiferromagnetic substance or the laminating ferrimagnetic substance, and the antiferromagnetic substance. [0017] As the high holding power magnetic substance of the aforementioned composition, the material whose holding power, such as CoPt, FePt, CoCrPt, CoTaPt, FeTaPt, and FeCrPt, is 100 or more Oes is desirable. [0018] Moreover, as the antiferromagnetic substance, PtMn, PtPdMn, FeMn, IrMn, NiMn, etc. are desirable. [0019] Moreover, it is desirable to use Cu, Ag, Au, Ru, Rh, Ir, Re, Os or the alloy of these metals, and an oxide as a non-magnetic material as the magnetic substance which has the multilayer structure of the magnetic substance and non-magnetic material, and is used as the laminating ferrimagnetic substance here, using FeCo containing Co or Co, CoFeNi, CoNi, CoZrTa, CoZrB, a CoZrNb alloy, etc. [0020] On the other hand, the 2nd magnetic layer realizes easy magnetization rotation compared with the 1st magnetic layer, and uses it as a free magnetic layer. [0021] When the bias seal of approval of the two magnetic substance which carried out spin polarization is carried out through the conductor in which the conduction like a barricade stick is possible, change of the magnetization relative angle between the two magnetic substance can be detected as the resistance change. This is considered to be the phenomenon in which conduct spin dispersion, without seldom receiving, are the connected magnetic-substance interface, and the spin polarization electron transmitted in the inside of a barricade stick conductor happens since it is reflected depending on the direction of spin polarization. [0022] In this case, by [which carry out a free magnetic layer] touching in a magnetization rotation suppression layer like this invention, considering as a fixed magnetic layer and having not touched another side in a magnetization rotation suppression layer, a magnetization relative angle is made clear, as a result, high power is obtained, and things are made. [0023] Drawing 2 shows typically the situation of operation of the magnetic resistance element of the foundations shown by drawing 1.

[0024] Like drawing 2 (a) and drawing 2 (b), the current value which flows for an element when that is not right falls under a constant-voltage bias seal of approval compared with the case where each magnetization direction of the two magnetic substance is parallel. [0025] Moreover, under a constant-current bias seal of approval, the voltage which flows for an element when that is not right increases like drawing 2 (c) and drawing 2 (d) compared with the case where each magnetization direction of the two magnetic substance is parallel. [0026] Here as a material used for the 1st magnetic layer or the 2nd magnetic layer Fe, Co, nickel, a FeCo alloy, a NiFe alloy, a CoNi alloy, a NiFeCo alloy, or FeN, FeTiN, FeAlN, FeSiN, FeTaN, FeCoN, FeCoTiN, FeCo(aluminum, Si) N, and FeCoTaN etc. -- a nitride -- TMA represented by an oxide, carbide, a boride, and the fluoride magnetic substance (T) At least

one sort chosen from Fe, Co, and nickel and M At least one sort chosen from Mg, calcium, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, aluminum, Si, Mg, germanium, and Ga and A At least one sort chosen from N, B, O, F, and C, or (Co, Fe) M (at least one sort as which M was chosen from Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cu, and B), Or FeCr, FeSiAl, FeSi, and FeAl, FeCoSi, FeCoAl, and FeCoSiAl, tangent line (T was chosen from Fe, Co, and nickel -- at least one sort) represented by FeCoTi, Fe(nickel) (Co) Pt, Fe (nickel), and (Co) Pd, Fe(nickel) (Co) Rh, Fe(nickel) (Co) Ir, Fe (nickel), and (Co) Ru, FePt, etc. L Cu, Ag, Au, Pd, and Pt, Rh, Ir, Ru, Os, and Ru, Si, germanium, aluminum, Ga, Cr, and Mo, at least one sort chosen from W, V, Nb, Ta, Ti, Zr, Hf, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, and Lu etc. -- a ferromagnetic -- moreover -- or Fe₃O₄ or XMnSb (at least one as which X was chosen from nickel, Cu, and Pt), LaSrMnO, LaCaSrMnO, the half metal material represented by CrO₂, or QDA (Q was chosen from Sc, Y, a lanthanoids, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, and Zn -- at least one sort) At least one sort and D as which A was chosen from C, N, O, F, and S RDA, such as at least one sort chosen from V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel or GaMnN, AlMnN, GaAlMnN, and AlBMnN (R) One sort and D which were chosen from B, aluminum, Ga, and In V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel from -- one selected sort and A have spinel type oxides, such as a magnetic semiconductor represented by one etc. sort chosen from As, C, N, O, P, and S or a perovskite type oxide, and a ferrite, and a desirable garnet type oxide [0027] Moreover, although any are sufficient as long as an insulator is insulating material, Mg, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, and Cr are included. IIa-VIa, La and Ce are included. A lanthanoids, Zn, B, aluminum, Ga, and Si are included. The element chosen from IIb-IVb and the thing which was chosen from F, O, C, N, and B and which are a compound with an element or a polyimide, and phthalocyanine system organic molecule material at least are desirable. [0028] Moreover, in order to use as a small barricade stick conductor of spin dispersion as a conductor, as for both the width of face of a conductor, and thickness, it is desirable that it is 100nm or less. As for especially the width of face and thickness of a conductor, for operation near the room temperature, it is more desirable that it is 50nm or less. It is desirable to use a carbon tube as a conductor which has such a property. Although a carbon tube exists variously from a monolayer to a multilayer thing, any may be used for it here. Moreover, it is desirable to use Si thin line in which the width of face of 10nm of numbers carried out the high concentration carrier dope from several nm. Moreover, you may constitute as a conductor the channel portion formed in the MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) type FET (field-effect transistor) structure or MES (Metal-Semiconductor) type FET structure created using the semiconductor base. As for the source section and the drain section, in that case, it is desirable to consist of the magnetic substance, and, as for the magnetic substance, it is still more desirable that it is a magnetic semiconductor. Moreover, as for the length of a conductor, it is desirable that it is [1nm or more] 1000nm or less. [0029] Moreover, as long as the start and resistivity are the material of 100 or less microohm-cm about nonmagnetic conductivity material, and Cu, aluminum, Ag, Au, Pt and TiN as a desirable material, any are sufficient as an electrode object. To especially a carbon tube, Au or Cr/Au is desirable. [0030] Moreover, a part of magnetization rotation suppression layer is arranged on an insulating base like drawing 3 (a) as a form of one operation, and between the 2nd magnetic substance and the two magnetic substance is arranged and constituted so that a conductor may cross the 1st magnetic substance on it and it may cross a level difference configuration on an insulating base. Conduction **** here is prepared as a conductor which performs conduction like a barricade stick, and constitutes a magnetic resistance element. The 2nd magnetic substance with which the 1st magnetic substance which touched the magnetization rotation suppression layer has not touched as the fixed bed constitutes the magnetic resistance element as a free layer. [0031] Under the present circumstances, it is desirable that the edge of the magnetization rotation suppression layer arranged on an insulating base is formed with an inclination like drawing 3 (b). Thus, it is desirable, when it has arranged and the thickness of a conductor can control by the angle. Especially, 70 degrees is suitable from 25 degrees in the angle preferably. When it was this range, the reappearance student was the best and the magnetic resistance element has been created. When using a carbon tube and it is in this range, bending [edge / of a carbon tube] has the desirable influence which the conduction property has few. In this case, you may be a slant-face configuration with the curved surface in this desirable angle range. [0032] Moreover, a part of insulator is arranged on a magnetization rotation suppression layer, in between the 1st magnetic substance and the two magnetic substance, it is arranged and drawing 3 (c) is constituted so that a conductor may cross a level difference configuration so that the 2nd magnetic substance and a magnetization rotation suppression layer may be directly touched on it. A conductor here is formed as a conductor which performs conduction like a barricade stick. The 2nd magnetic substance with which the 1st magnetic substance which touched the magnetization rotation suppression layer has not touched as the fixed bed constitutes the magnetic resistance element as a free layer, and is desirable. [0033] When a conductor touches a magnetization rotation suppression layer directly, as for a magnetic field rotation suppression layer, it is desirable that they are a semiconductor or an insulator. [0034] Here, in drawing 3 (e) of drawing 3 (a), drawing 3 (f) of drawing 3 (b) shows [drawing 3 (d)] the appearance of the upper surface plot plan of drawing 3 (c), respectively. [0035] A magnetization rotation suppression layer is formed in part into a nonmagnetic base, a conductor is arranged on it at the 1st magnetic substance, it is arranged between the 2nd magnetic substance and the two magnetic substance right above [insulating-base], and drawing 4 (a) is constituted. A conductor here is formed as a conductor which performs conduction like a barricade stick. The 2nd magnetic substance with which the 1st magnetic substance which touched the magnetization rotation suppression layer has not touched as the fixed bed constitutes the magnetic resistance element as a free layer. [0036] At least two or more

magnetic layers are formed in part into a nonmagnetic base, a conductor is arranged between two magnetic layers among those, a magnetization rotation suppression layer is arranged and drawing 4 (b) is constituted by the part on the 1st magnetic layer. A conductor here is formed as a conductor which performs conduction like a barricade stick. The 2nd magnetic layer with which the 1st magnetic layer which touched the magnetization rotation suppression layer is not in contact as the fixed bed constitutes the magnetic resistance element as a free layer. [0037] Under the present circumstances, the direction which the laminating of the magnetic substance is further carried out [direction] like drawing 4 (c) so that a conductor may be put by the upper and lower sides on the 1st magnetic layer, and contacts a magnetization rotation suppression layer on it is still more desirable although the 1st magnetic substance is used as the fixed bed. Moreover, as for the magnetic substance arranged on the 1st magnetic substance and the 2nd magnetic substance, it is desirable that it is the metal magnetic substance, and this arrangement is desirable [the magnetic substance] in electric contact being easy to be obtained. [0038] Moreover, like drawing 4 (d), at least two or more magnetic layers are formed in part into a nonmagnetic base, a conduction layer is formed between two magnetic layers among those, and the magnetization rotation suppression layer is arranged and constituted by the part on the 1st magnetic layer. A conductor here is formed as a conduction layer which performs conduction like a barricade stick. The 2nd magnetic layer with which the 1st magnetic layer which touched the magnetization rotation suppression layer is not in contact as the fixed bed constitutes the magnetic resistance element as a free layer. [0039] As for the magnetization rotation suppression layer formed into the nonmagnetic base shown by drawing 4 (a), it is desirable to be formed in the magnetic semiconductor which has ferromagnetism or antiferromagnetism. Under the present circumstances, as for this magnetic semiconductor, what has a substrate and at least one element of the same kind, and has the crystal structure of the same kind is desirable. [0040] It is desirable that conduction between the 1st magnetic layer and the 2nd magnetic layer is performed mainly through a conductor in the magnetic resistance element shown by drawing 4 (a), drawing 4 (b), drawing 4 (c), and drawing 4 (d), and, as for the meaning to a nonmagnetic base, it is desirable that they are an insulating substrate or a semiconductor substrate. [0041] As for the 1st magnetic layer and the 2nd magnetic layer which are formed into the nonmagnetic base shown by drawing 4 (b), drawing 4 (c), and drawing 4 (d), being formed in the magnetic semiconductor which has ferromagnetism is desirable. Under the present circumstances, as for this magnetic semiconductor, what has a substrate and at least one element of the same kind, and has the crystal structure of the same kind is desirable. [0042] When a conductor touches a magnetization rotation suppression layer directly also here, as for a magnetic field rotation suppression layer, it is desirable that they are a semiconductor or an insulator. [0043] Drawing 5 shows the magnetic resistance element constituted as a 3 terminal element. [0044] The electrode object is arranged through the insulator on the conductor for the gate electric-field seal of approval. Here, the drain section and 2nd magnetic-substance side is shown for the 1st magnetic-substance side as the source section for convenience. [0045] Although any are sufficient as long as it is insulating material as an insulator arranged between the gate electrode and the conductor Mg, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, and Cr are included especially. The lanthanoids and Zn containing IIa-VIa, La, and Ce, B, aluminum, Ga, and Si are included. The element chosen from IIb-IVb, It is desirable that is a compound with an element at least for having been chosen out of F, O, C, N, and B. Moreover, you may be phthalocyanine system organic molecule material. [0046] Drawing 6 shows typically the situation of operation of the magnetic resistance element of 3 terminal structures of the foundations shown by drawing 5. [0047] Like drawing 6 (a), when the magnetization direction of the 1st magnetic layer and the 2nd magnetic layer is parallel and the seal of approval of the gate voltage is not carried out, a spin polarization electron is transmitted in a conductor and current tends to flow between the magnetic substance in the bottom which carried out the seal of approval of the fixed voltage bias between the magnetic substance. On the other hand, like drawing 6 (b), when the seal of approval of the gate voltage is carried out, induction of the carrier is carried out to a conductor, and the amount of current between the magnetic substance detected falls by urging spin dispersion. Under the present circumstances, the resistance of an element to a gate voltage changes like drawing 21 (a). [0048] Moreover, like drawing 6 (c), when the magnetization directions of the 1st magnetic layer and the 2nd magnetic layer are anti-parallel, it sets. When not carrying out the seal of approval of the gate voltage, a spin polarization electron cannot be easily transmitted in a conductor. under a fixed voltage bias seal of approval While current could not flow easily between the magnetic substance, when the seal of approval of the gate voltage is carried out like drawing 6 (d), induction of the carrier is carried out to a conductor, and the amount of current between the increase of an electron which carried out spin reversal in efficiency, and the magnetic substance detected increases by urging spin dispersion. Under the present circumstances, the resistance of an element to a gate voltage changes like drawing 21 (b). [0049] As shown in drawing 7 (a), the electrode object for electric-field seals of approval can allot and constitute the magnetic resistance element of such 3 terminal structures through an insulator on the conductor of drawing 3 (a). Here, although shown using drawing 3 (a), even if it uses drawing 3 (b) and drawing 3 (c), a 3 terminal element can be constituted. [0050] Moreover, the electrode object for electric-field seals of approval can allot and constitute through an insulator like drawing 7 (b) on the conductor of drawing 4 (a). Here, although shown using drawing 4 (a), even if it uses drawing 4 (b) and drawing 4 (c), a 3 terminal element can be constituted. [0051] Moreover, the electrode object for electric-field seals of approval can allot and constitute through an insulator like drawing 7 (c) on the conductor of drawing 4 (d). Here, the channel portion formed in MES structure which minded an MOS structure or the Schottky barrier functions as a conductor. As for the source section and the drain

section, in that case, it is desirable to consist of the magnetic substance, and, as for the magnetic substance, it is still more desirable that it is a magnetic semiconductor. [0052] Furthermore, it is desirable even if it allots not only arrangement of drawing 5 but the gate polar zone like drawing 7 (d). [0053] here -- a magnetic semiconductor -- QDA (Q was chosen from Sc, Y, a lanthanoids, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, and Zn -- at least one sort) At least one sort and D as which A was chosen from C, N, O, F, and S RDA, such as at least one sort chosen from V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel or GaMnN, AlMnN, GaAlMnN, and AlBMnN (R) one sort and D which were chosen from B, aluminum, Ga, and In -- V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel from -- one selected sort and A are chosen from what is represented by one etc. sort chosen from As, C, N, O, P, and S [0054] Drawing 8 shows the situation of the magnetic resistance element which used the barricade stick conduction by the layered product. [0055] The composition which bears barricade stick conduction between the 2nd magnetic layer which is not in contact with the 1st magnetic substance which touched the magnetization rotation suppression layer like drawing 8 (a) and which ***** (ed) is shown. Such composition may arrange and constitute many conductors like drawing 8 (b). Moreover, it is desirable to arrange and constitute a nonmagnetic insulator like drawing 8 (c) around many conductors. [0056] Moreover, it is effective, even if it carries out the point contact of the 2nd magnetic substance to the 1st magnetic substance and constitutes it like drawing 8 (d). Furthermore, since the same effect is acquired even if it forms the narrow field which was made to elongate the magnetic substance like drawing 8 (e) as another gestalt, and was narrow in part, it is desirable. As for the extension portion in this case, it is desirable that it is at least 50nm or less. In these cases, a contact portion or an extension portion is in a superparamagnetism state, and functions mainly as a barricade stick conductor. [0057] When using a carbon tube as a conductor shown by drawing 8 (a), drawing 8 (b), and drawing 8 (c), it is desirable to use the buffer layer suitable for carbon tube orientation film creation, and functioning also as a magnetic film is most desirable. As a magnetic film here, Fe, Co, and nickel are suitable to carbon tube orientation, and it is especially Fe_xCoyNiz as a magnetic resistance element of this invention. ($0.1 < x < 1.0$, $0 < y < 0.8$, $0 < z < 0.9$, $x + y + z = 1$) Using is still more desirable. [0058] The composition of the above-mentioned this invention is realizable using a usual thin film process and a usual micro-processing process. To formation of each magnetic layer, an antiferromagnetism layer, a layer insulation layer, an electrode, etc., it is producible by PVD, such as the sputtering methods, such as a pulse laser deposition (PLD), an ion beam deposition (IBD), a cluster-ion beam or RF, DC and efficient consumer response, Helicon, ICP, or an opposite target, MBE, and the ion plating method, other CVD(s) and plating, or the sol gel process. [0059] Moreover, as micro processing, it can attain by physical or combining a chemical etching method and the photo lithography technology which used the stepper, the EB method, etc. for detailed pattern formation, such as ion milling used in a semiconductor process, a GMR head production process, etc., and RIE, FIB. Moreover, it is also effective to use CMP and cluster-ion beam etching for surface flattening, such as an electrode. [0060] Moreover, by using the magnetic resistance element of the aforementioned composition, the magnetic memory which obtains high power at the time of read-out is producible. [0061] The example of the magnetic memory using the magnetic resistance element of the above-mentioned composition as a memory device is shown in drawing 12. As an element used as memory, which composition of the magnetic resistance element of the aforementioned composition may be used. the intersection of the bit line which is a record line made based on Cu or aluminum as an element is represented by M (i, j) of drawing 12, and a word line -- a matrix -- it is arranged like and signaling information is recorded by 2 current coincidence method using the synthetic magnetic field generated when the signal current is passed on each line When the distance over the record layer of the element of a bit line and a word line differs, the seal of approval of the current is carried out to a both line so that a magnetic field efficient for element operation may carry out a seal of approval to a record layer. [0062] Next, when the time of this addressing is accelerated, inductive-coupling current or capacitive joint current may occur to a record line smell, and the cross talk of gestalt with one [another] more may arise because the interval between record lines narrows. As one method of suppressing these, as shown in drawing 17, it is desirable to prepare the tie grounded between record lines. Drawing 17 (a) shows the case of the arrangement which puts a magnetic resistance element like drawing 17 (b) as another gestalt, when the tie has been horizontally arranged to a word line. It is easy to concentrate at the free layer whose magnetic field is a record layer in the case of drawing 17 (b) and is desirable. Moreover, in order for wiring thickness to become large compared with wiring width of face and to have a longwise cross-section configuration as detailed-ization progresses, combination is easy to take and is more desirable [arrangement like drawing 17 (a)]. When such a tie is realized in the magnetic memory device of drawing 13 (b), wiring arrangement serves as composition like drawing 18. [0063] First, in drawing 13 and drawing 14, it explains to the basic example of write-in operation by the current of a magnetic memory device, and reading operation just. In addition, in each drawing, the magnetic resistance element shown in drawing 1 as an example is used as a memory device. [0064] By drawing 13 (a) and drawing 13 (b), in order to read the magnetization state of an element individually, the composition which prepared the switching device represented by FET for every element is shown. This magnetic memory can be easily constituted on a CMOS substrate. Moreover, drawing 13 (c) and drawing 13 (d) show the composition which used the nonlinear element or the rectifying device for every element. Here, a varistor, and a tunnel element or 3 terminal element of the aforementioned composition may be used for a nonlinear element. This magnetic memory can only increase the membrane formation process of diode etc., and can produce a substrate also on a cheap ** glass substrate. Here, the example in the case of drawing 13 (a) and drawing 13 (c) having arranged

two record layers in the upper part of an element, and having arranged both drawing 13 (b) and drawing 13 (d) in the upper part and the lower part of an element is shown. Moreover, in drawing 14, it is considering as the composition by which an element is arranged at the intersection of a direct word line and a bit line not using the switching device for isolation as shown in each drawing of drawing 13, or the rectifying device. Therefore, in drawing 14, in order that current may flow ranging over two or more elements at the time of read-out, it is desirable from the precision of read-out that they are 10000 or less elements. In 10000 or more elements, an output is no longer obtained enough. [0065] Although each drawing of drawing 13 shows the case where it uses together with the sense line which a bit line passes current for an element and reads resistance change, respectively, in order to prevent the malfunction and element destruction by bit current, you may prepare a sense line and a bit line separately. As for a bit line, at this time, it is desirable to be the position electrically insulated with the element, and to arrange to a sense line and parallel. Moreover, as for the distance between a word line, a bit line, and a memory cell, in current writing, it is desirable that it is about 500nm or less from the point of power consumption. [0066] Next, the example of the cellular structure of the multilayer-interconnection memory which performs the writing by the current magnetic field to drawing 15 and drawing 16 is shown. Drawing 15 is the multilayer interconnection produced on the switching device represented by FET, and drawing 16 shows the multilayer interconnection formed through the rectifying device or nonlinear element represented by diode and the tunnel element. A switching device, a rectifying device, or a nonlinear element carries out the work which performs electric separation of adjoining elements. When it is a multilayer interconnection without these electric separation elements, it is necessary to take the architecture which makes 1 block the aggregate of the memory cell of the 10000 maximum numbers from sense sensitivity. [0067] Moreover, at the time of output detection of the magnetic resistance element explained here, it is realizable by using a detector like drawing 19. For example, it is desirable, when wiring resistance and criteria element resistance can be canceled, it accumulates and high S/N-ization can be easily realized by taking an output difference with the comparison resistance including wiring resistance. [0068] When magnetic memory is constituted, comparison resistance can constitute desired magnetic memory, if it arranges as drawing 20 showed. [0069] To the word line and bit line for magnetic field generating which are used here, conductivity is high, and it is desirable to them that critical current density mainly uses Cu strong against 106-107 A/cm² and electromigration. Furthermore, mainly using the carbon tube which is 109 A/cm² also has critical current density effective in high magnetic field generating, and it is desirable. [0070] Furthermore, the example of concrete operation is shown below. [0071] (Example 1) The thin line of Si was first created using SOI (Silicon on Insulator) / SiO₂ substrate. [0072] The SOI layer thin-film-ized by thermal oxidation and wet etching was oxidized thermally, and SOI (20)/SiO₂ (25) was formed. Here, SiO₂ (25) themselves was used as a resist object, EB (electron beam) processing was given, and thin-line pattern drawing which has the width of face of five to 50 nm was performed. The amount of Dose(s) used for drawing in this case was 1-10 C/cm². It carried out to development using buffered fluoric acid (HF=0.2 mol/l, NH₄=0.2 mol/l). Then, RIE (reactive ion etching) was performed, the SOI layer was processed, again, the SiO₂ two-layer of a resist object was removed using buffered fluoric acid, and the thin line of Si of desired 5-50nm size was obtained. Then, thermal diffusion of Lynn using PSG (Lynn silicic-acid glass) was performed about about 10 minutes at 800 degrees C, it doped to the whole thin line, and conductivity was given. Carrier concentration in this case was set to 10¹⁷-10²¹/cm³. Furthermore, after Si thin-line creation, the insulating oxide film of about 1 - 5nm was created by thermal oxidation in the thin-line front face. Then, instant thermal oxidation was performed for the thin amorphous silicon layer, and Si dot whose path is about 2 - 10nm was formed on the thin line. Thereby, induction of the effect of single electronic char JINGU is carried out, and the KOTONNERU conduction effect is expected barricade stick-wise. The usual organic resist object was deposited on this micro-processing portion (drawing 9 (a)), plural spatters were used on it, and the sample was produced in the following ways. [0073] Sample 1Ta(1) / CoFe(15) / Ta (15) (the unit in a parenthesis is nm) As shown in this sample as shown in drawing 9 (b) through processes, such as a lift off, at drawing 9 (c), the arrangement configuration was acquired, and the arrangement also created the structure of drawing 9 (e) through the same photolithographic process after the antiferromagnetic substance PtMn(45) deposition (drawing 9 (d)) as a magnetization rotation suppression layer. The element was completed by finally, arranging electrode object Ta(5) / Cu (200) / Ta (50), as shown in drawing 9 (f). [0074] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior to the created element, and the electrical property between electrode objects was evaluated. The seal of approval of the seal of approval of a magnetic field was carried out in parallel with the longitudinal direction of a thin line. The size of the thin line at the time of evaluating was about 250nm in width of face of 10nm, the thickness of 20nm, and length. [0075] The magnetic-reluctance rate of change observed at the room temperature in the element which processed the sample 1 was about 8%. [0076] In order to evaluate an effect more notably, when it carried out under low temperature (5K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 30%. [0077] Here, although the process shown in drawing 9 realized element processing, if the element for which not only this but ** has the same structure is realizable, this invention will not be restricted to this in order to demonstrate a desired effect. [0078] Moreover, although CoFe was used as the magnetic substance here, magnetic-reluctance change was observed also in Fe, Co, nickel, a FeCo alloy, a NiFe alloy, a CoNi alloy, a NiFeCo alloy or FeCr, FeSiAl, FeSi, FeAl, FeCoSi, FeCoAl, FeNiPt, FePd, FeRh, FeIr, FeRu, FePt, and FeV. [0079] Moreover, as a conductor, although Cu was mainly used, even if it used aluminum, Ag, Au, and Pt, magnetic-

reluctance change was observed. [0080] Moreover, as the antiferromagnetic substance, although PtMn was used, even if it used PtPdMn, FeMn, IrMn, and NiMn, magnetic-reluctance change was observed. [0081] (Example 2) On Si/SiO₂ substrate, it arranges in the position of a request of a carbon tube within *****, and an electrode configuration pattern is beforehand formed in a resist. Besides, SiO₂ two-layer was deposited and the reverse pattern of an electrode configuration was formed in the lift off after that. [0082] Next, the sample was produced in the following ways using plural spatters. [0083] Sample 2AuCr(0 or 0.5)/CoFe (45)/Ta(15) sample 3AuCr(0 or 0.5)/AlO(0.5)/CoFe(45) / Ta (15) (a unit is nm) And the element as finally shown in drawing 1 was completed using the photolithographic method shown in drawing 9 as fundamental technique. [0084] Here, as for a length of about 250nm in the minimum section, and width of face and height, between the magnetic substance was about 3nm in a part for the diameter of a carbon tube, using a monolayer carbon tube as a conductor. SiO₂ (200nm) was used as an insulator for the protection on a conductor. PtMn (60) was used as the antiferromagnetic substance, Ta(5) / Cu (200) / Ta (50) was used as an electrode object, and the element was completed. [0085] In addition, the value in AlO ((of)) showed the total value of the design thickness of aluminum before oxidation treatment, and repeated and produced oxidizing aluminum in oxygen content atmosphere after 0.3 - 0.7nm membrane formation in fact. In this example, 0.5nm aluminum is oxidized and it is creating. [0086] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior to the created element, and the electrical property between electrode objects was evaluated. The seal of approval of the seal of approval of a magnetic field was carried out in parallel with the longitudinal direction of a thin line. [0087] In the element which processed the sample 2, the magnetoresistance effect was observed at the room temperature. [0088] In order to evaluate an effect more notably, when it carried out under low temperature (5K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 12% (refer to drawing 22). [0089] Moreover, the magnetoresistance effect was observed also in the element which processed the sample 3. [0090] When carried out under low temperature (5K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 22%. It has suggested that the direction at the time of minding an insulator between the carbon tubes which are the magnetic substance and a conductor is efficient, and pouring of a spin polarization electron is possible. [0091] Here, although the process shown in drawing 9 realized element processing, if the element for which not only this but ** has the same structure is realizable, this invention will not be restricted to this in order to demonstrate a desired effect. [0092] Moreover, although CoFe was used as the magnetic substance here, magnetic-reluctance change was observed also in Fe, Co, nickel, a FeCo alloy, a NiFe alloy, a CoNi alloy, a NiFeCo alloy, a NiFeCo-cyanogen complex or FeN, FeTiN, FeAlN, FeSiN, FeTa₂N, FeCoN, FeCoTiN, FeCoAlSiN, FeCoTa₂N or CoFeV, CoFePt, CoFeTa, and CoFeB. [0093] Since the same effect is acquired as a conductor even if it uses a multilayer carbon tube although the monolayer carbon tube was used here, it does not restrict to this. The width of face of the tube in this case is 2nm - about 30nm. [0094] Moreover, as an electrode object, although Cu was mainly used, even if it used aluminum, Ag, Au, and Pt, magnetic-reluctance change was observed. [0095] Moreover, as the antiferromagnetic substance, even if it used not only PtMn but PtPdMn, FeMn, IrMn, and NiMn, magnetic-reluctance change was observed. [0096] Or since one side of a magnetic electrode had high coercive force on parenchyma even if it arranges CoPt which is the high holding power magnetic substance instead of the antiferromagnetic substance, FePt, CoCrPt, CoTaPt, FeTaPt, and FeCrPt, a desired magnetic-reluctance change has been observed. [0097] (Example 3) The sample was produced in the following ways using plural spatters on the Si/SiO₂ substrate. [0098] Sample 4NiO(50) / Ta (5) (a unit is nm) And a method photolithographic as fundamental technique is used. After processing the film of a sample 4 into a desired pattern and carrying out the spatter of the Ta of the sample 4 film upper layer using a reverse spatter after that The carbon tube has been arranged in the position of the processing edge of sample 4 film within ***** on it, AuCr(0 or 0.5)/AlO(0.5)/CoFe (30nm) / Ta (15) was deposited and processed as a magnetic film, and the element of arrangement of drawing 3 (b) was completed. It is most suitable to make the angle of the slant face at this time into 70 degrees from 25 degrees. When it was this range, the reappearance student was the best and the magnetic resistance element has been created. When using a carbon tube and it is in this range, bending [edge / of a carbon tube] has the desirable influence which the conduction property has few. [0099] As for a length of about 250nm in the minimum section, and width of face and height, between the magnetic substance was about 3nm in a part for the diameter of a carbon tube here, using a monolayer carbon tube as a conductor. SiO₂ (200nm) is used as an insulator for the protection on a conductor. The element was completed using Ta(5) / Cu (200) / Ta (50) as an electrode object. [0100] as this example shows, the direction which patternizes beforehand in the antiferromagnetism layer which is a magnetization rotation suppression layer, and arranges a conductor on it completes an element -- arrangement of drawing 1 -- eye a simple hatchet -- it is desirable when the direction of arrangement of drawing 3 (b) performs micro processing of a conductor, and when [furthermore,] arranging in a minute position -- arrangement of drawing 3 (a) -- eye a simple hatchet -- it is desirable < BR > [0101] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior, and the electrical property between electrode objects was evaluated. [0102] In the element which processed the sample 4, the magnetoresistance effect was observed at the room temperature. [0103] In order to evaluate an effect more notably, when it carried out under low temperature (5K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 22%. [0104] Here, although the process shown in drawing 9 realized element processing, if the element for which not only this but ** has the same structure is realizable, this invention will not be restricted to this in order to demonstrate a desired effect. [0105] Then, insulating body membrane SiO₂ for protection to the

carbon tube top which is the conductor of the element which processed and created the sample 4 (100nm) Instead, the gate electrode for electric-field seals of approval has been arranged through another insulator. The used insulator used Cu phthalocyanine film (50nm) / Cu (150) / Ta (50) as a phthalocyanine film (5nm) and an electrode object. [0106] When the electric-field seal of approval was changed from -1V to 5V, the magnetic-reluctance change was measured at the room temperature using the gate electrode, an electric-field seal of approval is zero and the magnetization direction of both magnetic layers gathers, the property that resistance becomes low compared with except [it] is shown. When behavior with a magnetic-reluctance change complicated when 1V seal of approval of the electric field is carried out from 0 was shown and the magnetization direction gathered by the case, resistance did not necessarily become low. Furthermore, if the seal of approval of the electric field is carried out, magnetic-reluctance change will no longer be seen by about 5 V. Thereby, a magnetic-reluctance property is controllable by the electric-field seal of approval. [0107] Moreover, although CoFe was used as the magnetic substance here, even if it used Fe, Co, nickel, the FeCo alloy, the NiFe alloy, the CoNi alloy, and the NiFeCo alloy, magnetic-reluctance change was observed. [0108] Moreover, although the phthalocyanine was used as an insulator of the gate section, the advantage in which the affinity of both carbon tube and phthalocyanine was very good here, and a contact interface could create smoothly was checked. [0109] Moreover, as an electrode object, although Cu was mainly used, even if it used aluminum, Ag, Au, and Pt, magnetic-reluctance change was observed. [0110] Moreover, although insulating NiO was used as the antiferromagnetic substance, even if it used alpha-Fe₂O₃, CrO/NiO, and RFeO₃ (R is rare earth elements and is La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, and Yb), magnetic-reluctance change was observed. [0111] (Example 4) By the same technique as an example 1, the thin line of Si was first created using SOI/SiO₂ substrate. [0112] After obtaining the thin line of Si of desired 5-50nm size, thermal diffusion of Lynn using PSG (Lynn silicic-acid glass) was performed about about 10 minutes at 800 degrees C, it doped to the whole thin line, and conductivity was given. Carrier concentration in this case was set to 1019-/cm³. Furthermore, after Si thin-line creation, the about 2.5nm insulating oxide film was created by thermal oxidation in the thin-line front face. Furthermore, after Si thin-line creation, the insulating oxide film of about 1 - 5nm was created by thermal oxidation in the thin-line front face. Then, instant thermal oxidation was performed for the thin amorphous silicon layer, and Si dot whose path is about 2 - 10nm was formed on the thin line. Thereby, the effect of single electronic char JINGU is expected. Besides about 20 - 100nm of TEOS (tetrapod ethoxy run) films was deposited, and the poy-Si gate was further created as a gate electrode on this. The created gate width was created by ten to 100 nm using the detailed-ized technology of O₂ ashing. As a type of this example, it was about 40nm. The usual organic resist object was deposited on this micro-processing portion, plural spatters were used on it, and the sample was produced in the following ways. [0113] Sample 5Ta(1) / CoFe(15) / Ta (15) (the unit in a parenthesis is nm) Creation of an element was performed like the time of an example 1 according to the process of drawing 9 . The element was completed by finally, arranging electrode object Ta(5) / Cu (200) / Ta (50), as shown in drawing 9 (f). Moreover, PtMn (50) was used as the antiferromagnetic substance. [0114] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior to the created element, and the electrical property between electrode objects was evaluated under the gate electric-field seal of approval. The seal of approval of the seal of approval of a magnetic field was carried out in parallel with the longitudinal direction of a thin line. [0115] When the electric-field seal of approval was changed from -1V to 5V, the magnetic-reluctance change was measured at the room temperature using the gate electrode, an electric-field seal of approval is zero and the magnetization direction of both magnetic layers gathers, the property that resistance becomes low compared with except [it] is shown. When behavior with a magnetic-reluctance change complicated when 1V seal of approval of the electric field is carried out from 0 was shown and the magnetization direction gathered by the case, resistance did not necessarily become low. Furthermore, if the seal of approval of the electric field is carried out, magnetic-reluctance change will no longer be seen by about 5 V. Thereby, a magnetic-reluctance property is controllable by the electric-field seal of approval. [0116] The magnetic-reluctance rate of change observed at the room temperature in the element which processed the sample 5 was about 8%. [0117] In order to evaluate an effect more notably, when it carried out under low temperature (5K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 30%. [0118] Here, although the process shown in drawing 9 realized element processing, if the element for which not only this but ** has the same structure is realizable, this invention will not be restricted to this in order to demonstrate a desired effect. [0119] Moreover, although CoFe was used as the magnetic substance here, magnetic-reluctance change was observed also in Fe, Co, nickel, a FeCo alloy, a NiFe alloy, a CoNi alloy, a NiFeCo alloy or FeCr, FeSiAl, FeSi, FeAl, FeCoSi, FeCoAl, FeNiPt, FePd, FeRh, FeIr, FeRu, FePt, and FeV. [0120] Moreover, as a conductor, although Cu was mainly used, even if it used aluminum, Ag, Au, and Pt, magnetic-reluctance change was observed. [0121] Moreover, as the antiferromagnetic substance, although PtMn was used, even if it used PtPdMn, FeMn, IrMn, and NiMn, magnetic-reluctance change was observed. [0122] (Example 5) On Si/SiO₂ substrate, it arranges in the position of a request of a carbon tube within *****, and an electrode configuration pattern is beforehand formed in a resist. Besides, SiO two-layer was deposited and the reverse pattern of an electrode configuration was formed in the lift off after that. [0123] Next, the sample was produced in the following ways using plural spatters. [0124] Sample 6AuCr(0 or 0.5)/AlO(0.5)/CoFe(45) / Ta (15) (a unit is nm) And the element as finally shown in drawing 7 (d) was completed using the photolithographic method shown in drawing 9 as fundamental technique. The SiO₂ gate oxide film of the thermal oxidation which is a nonmagnetic insulator is about 100 to 300 nm, and used

Si substrate as a gate electrode. [0125] Here, as for a length of about 150nm in the minimum section, and width of face and height, between the magnetic substance was about 3nm in a part for the diameter of a carbon tube, using a monolayer carbon tube as a conductor. SiO₂ (200nm) was used as an insulator for the protection on a conductor. PtMn (60) was used as the antiferromagnetic substance, Ta(5) / Cu (200) / Ta (50) was used as an electrode object, and the element was completed. [0126] In addition, the value in AlO ((of)) showed the total value of the design thickness of aluminum before oxidation treatment, and repeated and produced oxidizing aluminum in oxygen content atmosphere after 0.3 - 0.7nm membrane formation in fact. In this example, 0.5nm aluminum is oxidized and it is creating. [0127] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior to the created element, and the electrical property between electrode objects was evaluated. The seal of approval of the seal of approval of a magnetic field was carried out in parallel with the longitudinal direction of a thin line. [0128] In the element which processed the sample 6, the magnetoresistance effect was observed at the room temperature. [0129] When carried out under low temperature (5K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 20%. The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior to the created element, and the electrical property between electrode objects was evaluated under the gate electric-field seal of approval. The seal of approval of the seal of approval of a magnetic field was carried out in parallel with the longitudinal direction of a thin line. [0130] When the electric-field seal of approval was changed from -1V to 5V, the magnetic-reluctance change was measured at the room temperature using the gate electrode, an electric-field seal of approval is zero and the magnetization direction of both magnetic layers gathers, the property that resistance becomes low compared with except [it] is shown. When behavior with a magnetic-reluctance change complicated when 1V seal of approval of the electric field is carried out from 0 was shown and the magnetization direction gathered by the case, resistance did not necessarily become low. Furthermore, if the seal of approval of the electric field is carried out, magnetic-reluctance change will no longer be seen by about 5 V. Thereby, a magnetic-reluctance property is controllable by the electric-field seal of approval. [0131] Moreover, although CoFe was used as the magnetic substance here, magnetic-reluctance change was observed also in Fe, Co, nickel, a FeCo alloy, a NiFe alloy, a CoNi alloy, a NiFeCo alloy, a NiFeCo-cyanogen complex or FeN, FeTiN, FeAlN, FeSiN, FeTa₂N, FeCoN, FeCoTiN, FeCoAlSiN, FeCoTa₂N or CoFeV, CoFePt, CoFeTa, and CoFeB. [0132] Since the same effect is acquired as a conductor even if it uses a multilayer carbon tube although the monolayer carbon tube was used here, it does not restrict to this. The width of face of the tube in this case is 2nm - about 30nm. [0133] Moreover, as an electrode object, although Cu was mainly used, even if it used aluminum, Ag, Au, and Pt, magnetic-reluctance change was observed. [0134] Moreover, as the antiferromagnetic substance, even if it used not only PtMn but PtPdMn, FeMn, IrMn, and NiMn, magnetic-reluctance change was observed. [0135] Or since one side of a magnetic electrode had high coercive force on substance even if it arranges CoPt which is the high holding power magnetic substance instead of the antiferromagnetic substance, FePt, CoCrPt, CoTaPt, FeTaPt, and FeCrPt, a desired magnetic-reluctance change has been observed. [0136] (Example 6) The plural molecular-beams epitaxy technique was used on the GaAs (001) substrate, and the sample was produced in the following ways. [0137] Sample 7GaAs(100)/MnAs(15) sample 8GaAs(100)/MnAs (50) (a unit is nm) A substrate is made to defecate under the atmosphere by As flux irradiation at about 600 degrees C, it was made to deposit in the elevated temperature of about 600 degrees C by having made the GaAs layer into the buffer layer, and the MnAs layer was made to once deposit after slight Mn flux irradiation by the 200-250-degree C basis on it to a GaAs substrate with this sample. Deposited MnAs makes the field (-1101) the growth side. Moreover, from magnetization measurement of the film made to deposit, it was checked that both easy axes have the [-110] GaAs direction in both samples. [0138] Using photolithographic technique as shown in this sample at drawing 9 , it forms in the pattern configuration of a request of a positive resist as mask material, and is processed into the thin film of the samples 7 and 8 which are the magnetic substance so that it may become a resist pattern configuration using the dry etching by argon ion irradiation. Furthermore, a conductor is deposited on it and a desired configuration is acquired by the lift off. Moreover, a case performs configuration processing here using the photolithographic technique that the conductor was further explained here when it was required to make barricade stick conduction into the configuration to manage. Moreover, it also checked that it did not matter even if it performs direct configuration processing using the associated equipment suitable for micro processing, such as a clock short hand of an electron beam, a converged type ion beam, and scanned type tunnel-current observation equipment accompanying, of course. Furthermore, by the case, when passivation is required, an insulator layer is deposited on a conductor. [0139] Here, the used conductor is Au (10nm) film, and is electronic dew in exposure about a positive resist as mask material. The conductor performed a length of about 80nm in the minimum section, and, as for width of face, the minimum section processed magnetic inter-electrode one] it in about 10nm. An insulator layer is SiO₂. (100nm) It used. [0140] Next, the sample 7 and the sample 8 gave deposition and processing for PtMn (60) as the antiferromagnetic substance, gave deposition and processing for Ta(5) / Pt (200) / Ta (50) as an electrode object, and realized structure of drawing 9 (f). [0141] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior, and the electrical property between electrode objects was evaluated. [0142] The magnetoresistance effect was observed in the element which processed the sample 7 and the sample 8. [0143] In order to evaluate an effect more notably, when it carried out under the room temperature (300K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 11% in the sample 6 a maximum of 10% in the sample 5. Furthermore in the bottom of low temperature (5K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum

of 20% in the sample 8 a maximum of 18% in the sample 7. [0144] Furthermore, using a monolayer carbon tube as a conductor, a length of about 250nm in the minimum section, and width of face and height realized composition of the same drawing 9 (f) in about 20nm, and between the magnetic substance evaluated the electrical property by composition of a sample 8. [0145] The magnetoresistance effect was observed also in this element. [0146] When carried out under the room temperature (300K), the magnetic-reluctance rate of change of magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 22% under low temperature (5K) further a maximum of 13%. [0147] Here, although the process shown in drawing 9 realized element processing, if the element for which not only this but ** has the same structure is realizable, this invention will not be restricted to this in order to demonstrate a desired effect. [0148] Moreover, although MnAs which is manganese PUNIKUTAI (Mn-V group element) as the magnetic substance here was used MnSb of the same kind or QDA (Q was chosen from Sc, Y, a lanthanoids, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, and Zn -- at least one sort) At least one sort and D as which A was chosen from C, N, O, F, and S RDA, such as at least one sort chosen from V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel or GaMnN, AlMnN, GaAlMnN, and AlBMnN (R) one sort and D which were chosen from B, aluminum, Ga, and In -- V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel from -- even if one selected sort and A use what is represented by one etc. sort chosen from As, C, N, O, P, and S, magnetic-reluctance change is checked [0149] Moreover, as a conductor, although Cu was mainly used, even if it used aluminum, Ag, and Pt, magnetic-reluctance change was observed. [0150] Moreover, as the antiferromagnetic substance, although PtMn was used, even if it used PtPdMn, FeMn, IrMn, and NiMn, magnetic-reluctance change was observed. [0151] (Example 7) The plural molecular-beams epitaxy technique was used on the GaAs (001) direction substrate, and the sample was produced in the following ways. [0152] Sample 9GaAs(100)/MnAs(15) sample 10GaAs(100)/MnAs (50) (a unit is nm) Make a substrate defecate in an atmosphere according a GaAs substrate to As flux irradiation at about 600 degrees C, it was made to deposit in the elevated temperature of about 600 degrees C by having made the GaAs layer into the buffer layer on it, and the MnAs layer was made to deposit with this sample by carrying out little irradiation of the As flux, and irradiating Mn after that at further 200-250 degrees C, in addition to As irradiation. Deposited MnAs makes the field (-1100) the growth side. From magnetization measurement of the film made to deposit, it was checked that the easy axis has the [110] GaAs direction in both samples of both. [0153] The process same with having been shown in the example 5 among this sample at the sample 9 realized structure of drawing 9 (f). [0154] The used conductor is Au (10nm) film, and is electronic dew in exposure about a positive resist as mask material. The conductor performed a length of about 80nm in the minimum section, and, as for width of face, the minimum section processed [magnetic inter-electrode one] it in about 10nm. An insulator layer is SiO₂. (100nm) It used. PtMn (60) was used as the antiferromagnetic substance and Ta(5) / Pt (200) / Ta (50) was used as an electrode object. [0155] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior, and the electrical property between electrode objects was evaluated. [0156] The magnetoresistance effect was observed in the element which processed the sample 7. [0157] In order to evaluate an effect more notably, when it carried out under the room temperature (300K), the magnetic-reluctance rate of change of magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 25% under low temperature (5K) further a maximum of 13%. [0158] On the other hand, it turns out that a sample 10 is mainly the antiferromagnetic substance from the result of magnetization measurement. Then, the film of a sample 8 is processed into a desired configuration using photolithographic technique, CoFe is deposited and processed as the magnetic substance on it, Au (10nm) film is used as a conductor, and it is electronic dew in exposure about a positive resist as mask material. It is an insulator layer SiO₂ on it. (100nm) It deposited. Composition of drawing 3 (b) was realized using Ta(5) / Pt (200) / Ta (50) as an electrode object. [0159] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior also here, and the electrical property between electrode objects was evaluated. [0160] The magnetoresistance effect was observed in the element which processed the sample 10. [0161] When carried out under the room temperature (300K), the magnetic-reluctance rate of change of magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 28% under low temperature (5K) further a maximum of 16%. [0162] Furthermore, using a monolayer carbon tube as a conductor, a length of about 250nm in the minimum section, and width of face and height realized composition of drawing 3 (b) in about 20nm, and between the magnetic substance evaluated the electrical property by composition of a sample 10. [0163] CoFe was used as the magnetic substance and Ta(5) / Pt (200) / Ta (50) was used as an electrode object. [0164] The magnetoresistance effect was observed also in this element. [0165] When carried out under the room temperature (300K), the magnetic-reluctance rate of change of magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 38% under low temperature (5K) further a maximum of 18%. [0166] Moreover, although MnAs was used as the magnetic substance of a sample 9 here MnSb of the same kind or QDA (Q was chosen from Sc, Y, a lanthanoids, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, and Zn -- at least one sort) At least one sort and D as which A was chosen from C, N, O, F, and S RDA, such as at least one sort chosen from V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel or GaMnN, AlMnN, GaAlMnN, and AlBMnN (R) one sort and D which were chosen from B, aluminum, Ga, and In -- V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel from -- even if one selected sort and A use what is represented by one etc. sort chosen from As, C, N, O, P, and S, magnetic-reluctance change is checked [0167] Moreover, although MnAs was used as what shows antiferromagnetism according to membrane formation conditions like a sample 10, this is considered that the structural distortion and pressure are acting on change of magnetic property greatly. Therefore, even if it used the matter which has the antiferromagnetism caused by distortion and pressure induction, or carrier pouring as a magnetization rotation suppression layer, it was checked that this

invention is realizable. [0168] Moreover, although CoFe was used as the magnetic substance in the sample 10, even if it used Fe, Co, nickel, the FeCo alloy, the NiFe alloy, the CoNi alloy, and the NiFeCo alloy, magnetic-reluctance change was observed. [0169] Moreover, as a conductor, although Pt was mainly used, even if it used aluminum, Ag, and Cu, magnetic-reluctance change was observed. [0170] Moreover, as the antiferromagnetic substance, although PtMn was used, even if it used PtPdMn, FeMn, IrMn, and NiMn, magnetic-reluctance change was observed. [0171] (Example 8) The plural molecular-beams epitaxy technique was used on the GaAs (001) direction substrate, and the sample was produced in the following ways. As an example 7 shows, in the magnetic resistance element shown in the example 7 which drawing 3 (b) constituted from composition of a sample 10, using a monolayer carbon tube as a conductor, the gate electrode for electric-field seals of approval has been arranged through an insulator to some conductors like drawing 10 (this composition applies to the composition of drawing 7 (a) correspondingly). The typical values of d in this example and D are 30nm and 250nm. [0172] When carried out under the room temperature (300K), magnetic-reluctance rate of change showed the electric field effect like drawing 11 by the gate electric-field seal of approval a maximum of 18% by the gate electric-field zero state, and magnetic-reluctance change also became zero in gate-voltage 6V. [0173] Moreover, although MnAs was used as the magnetic substance of a sample 7 here MnSb of the same kind or QDA (Q was chosen from Sc, Y, a lanthanoids, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, and Zn -- at least one sort) At least one sort and D as which A was chosen from C, N, O, F, and S RDA, such as at least one sort chosen from V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel or GaMnN, AlMnN, GaAlMnN, and AlBMnN (R) one sort and D which were chosen from B, aluminum, Ga, and In -- V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel from -- even if one selected sort and A use what is represented by one etc. sort chosen from As, C, N, O, P, and S, magnetic-reluctance change is checked [0174] Moreover, although MnAs was used as what shows antiferromagnetism according to membrane formation conditions as shown in the example 7, this is considered that the structural distortion and pressure are acting on change of magnetic property greatly. Therefore, even if it used the matter which has the antiferromagnetism caused by distortion and pressure induction, or carrier pouring as a magnetization rotation suppression layer, it was checked that this invention is realizable. [0175] Moreover, although CoFe was used as the magnetic substance in the sample 10, even if it used Fe, Co, nickel, the FeCo alloy, the NiFe alloy, the CoNi alloy, and the NiFeCo alloy, magnetic-reluctance change was observed. [0176] Moreover, as a conductor, although Pt was mainly used, even if it used aluminum, Ag, and Cu, magnetic-reluctance change was observed. [0177] Moreover, as the antiferromagnetic substance, although PtMn was used, even if it used PtPdMn, FeMn, IrMn, and NiMn, magnetic-reluctance change was observed. [0178] (Example 9) By using the ion-implantation technique to a GaAs (001) substrate top, the pouring-among GaAs substrate field of Mn ion was created. Mn ion was generated in the spatter. Mn ion produced in the spatter was drawn in the ion acceleration section, and it poured into the depth field from a GaAs substrate front face to about 50nm by about 100 keVs of acceleration voltage further. It is thought that a pouring carrier is about about 5.5% as x amounts converted as As (Ga1-xMnx) about [about 4x1020cm⁻³] by three. The Curie temperature estimated from magnetization measurement was about 100K. [0179] On the base in which such ferromagnetism was formed, it has arranged in the position of a request of a carbon tube within *****, and after that, PtMn (50nm) was deposited and processed on one pouring field, and the element with the composition of drawing 4 (b) was created. [0180] It is an insulator layer SiO₂ on the carbon tube which is a conductor. (100nm) Moreover, as an electrode object, Ta(5) / Pt (200) / Ta (50) was used. [0181] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior, and the electrical property between electrode objects was evaluated. [0182] When measured under low temperature (5K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 10%. [0183] Then, insulating body membrane SiO₂ for protection to the carbon tube top which is the conductor of the element which processed and created the sample of the created this example (100nm) Instead, the gate electrode for electric-field seals of approval has been arranged through an insulator. The used insulator used Ta(5) / Cu (200) / Ta (50) as a phthalocyanine film (50nm) and an electrode object. [0184] When the electric-field seal of approval was changed from -1V to 5V, the magnetic-reluctance change was measured using the gate electrode, an electric-field seal of approval is zero and the magnetization direction of both magnetic layers gathers, the property that resistance becomes low compared with except [it] is shown. When behavior with a magnetic-reluctance change complicated when 1V seal of approval of the electric field is carried out from 0 was shown and the magnetization direction gathered by the case, resistance did not necessarily become low. Furthermore, if the seal of approval of the electric field is carried out, magnetic-reluctance change will no longer be seen by about 5 V. Thereby, a magnetic-reluctance property is controllable by the electric-field seal of approval. [0185] Moreover, although As was used as the magnetic substance (Ga, Mn) here QDA(s) (Q was chosen from Sc, Y, a lanthanoids, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, and Zn -- at least one sort), such as ZnDO or AlDN At least one sort and D as which A was chosen from C, N, O, F, and S RDA, such as at least one sort chosen from V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel or GaMnN, AlMnN, GaAlMnN, and AlBMnN (R) one sort and D which were chosen from B, aluminum, Ga, and In -- V, Cr, Mn, Fe, Co, and nickel from -- even if one selected sort and A use what is represented by one etc. sort chosen from As, C, N, O, P, and S, magnetic-reluctance change is checked [0186] Moreover, as a conductor, although Cu was mainly used, even if it used aluminum, Ag, Au, and Pt, magnetic-reluctance change was observed. [0187] Moreover, as the antiferromagnetic substance, although PtMn was used, even if it used PtPdMn, FeMn, IrMn, and NiMn, magnetic-reluctance change was observed. [0188] (Example 10) On porous Si substrate which *****ed electrochemically and was created using acetylene

gas, Fe (50) was made in the desired place to carry out patterning in electron beam evaporation, and it was crowded. This Fe film works as a catalyst of a carbon tube orientation film. Carbon supply by methane is mainly performed, and orientation of the carbon tube created using CVD is carried out so that a longitudinal direction may stand to a film surface in the shape of a Fe film. Moreover, it turns out that Fe of a catalyst has adhered at the nose of cam of the carbon tube which carried out orientation. Ta [CoFe(50) / PtMn(50) /] (15)/Au (200) was made to deposit on this by electron beam evaporation and the spatter, and the laminating type element using the carbon tube was created. [0189] The seal of approval of the magnetic field was carried out from the exterior, and the electrical property between electrode objects was evaluated. [0190] In the processed element, the magnetoresistance effect was observed at the room temperature. [0191] In order to evaluate an effect more notably, when it carried out under low temperature (5K), magnetic-reluctance rate of change was a maximum of 9%. [0192] Moreover, although Fe and FeCo were used as the magnetic substance here, even if it uses nickel, Co, or a NiCoFe alloy, while there is a catalysis, magnetic-reluctance change is checked. [0193] Moreover, as the antiferromagnetic substance, although PtMn was used, even if it used PtPdMn, FeMn, IrMn, and NiMn, magnetic-reluctance change was observed. [0194] Or since one side of a magnetic electrode had high coercive force on parenchyma even if it arranges CoPt which is the high holding power magnetic substance instead of the antiferromagnetic substance, FePt, CoCrPt, CoTaPt, FeTaPt, and FeCrPt, a desired magnetic-reluctance change has been observed. [0195] (Example 11) Accumulation memory was produced by the memory device of basic composition as shown on a CMOS substrate at drawing 12. The element array made 16x16 memory 1 block, and could be a total of 8 blocks. Here, sample 11Ta(1) / CoFe(15) / Ta (15) was used for the element with (b) composition of drawing 13. [0196] The element cross section of a sample is 0.2micrometerx0.3micrometer, a free magnetic layer is set to NiFe (2), and the configuration is made into drawing 23 (a). [0197] Moreover, all of a word line, a bit line, etc. used Cu. [0198] By the synthetic magnetic field of a word line and a bit line, flux reversal of each free magnetic layer was simultaneously performed to eight elements of eight blocks, and the every 8 bits signal was recorded. Next, it was attached to each block, and turned on at a time the one gate of FET produced with CMOS, and sense current was passed. At this time, the comparator compared the bit line within each block, an element and the voltage generated in FET, and dummy voltage, and 8-bit information was simultaneously read in the output voltage of each element. [0199] The ratio of the major axis of the free magnetic layer in this case and a minor axis set to 1.5:1 (a major axis is 0.2 micrometers), and produced the accumulation memory which changed the configuration into drawing 23 (a) - (e). The power consumption which record of such memory takes was about about 3 of the configuration of drawing 23 (a) / five to 1/2 in the configuration of (b) - (e) of drawing 23. [0200] [Effect of the Invention] As explained above, according to this invention, the two magnetic substance has touched through at least one conductor. By constituting the magnetic resistance element characterized by resistance changing with change of the magnetization relative angle of the two magnetic substance with which a magnetization rotation suppression layer touches **, and only one side sandwiches the aforementioned conductor between the two magnetic substance It can use as the magnetic memory which records and reads information, and various magnetic devices using resistance change of the magnetoresistance-effect section by using as the free magnetic substance the magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer. For this reason, the property of the stress, acceleration sensor or heat sensor which detects the reproducing head of magnetic recording media, such as a magneto-optic disk used for the conventional information communication terminal etc., a hard disk, a digital data streamer tape drive (DDS), and digital VTR, and a cylinder, the magnetic sensor for rotational-speed detection of an automobile etc., magnetic memory (MRAM), stress change, acceleration change, etc., a chemical reaction sensor, etc. can be raised.

CLAIMS

[Claim(s)] [Claim 1] The magnetic resistance element characterized by resistance changing with change of the magnetization relative angle of the two magnetic substance which the 1st magnetic substance with which the magnetization rotation suppression layer touched between at least two magnetic substance, and the 2nd magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer have touched through at least one conductor, and sandwiches the aforementioned conductor. [Claim 2] The magnetic resistance element carry out as the feature carry out that resistance changes by change of the magnetization relative angle of the two magnetic substance which the 2nd magnetic substance which is arranged as sandwiches the 1st magnetic substance, the aforementioned magnetization rotation suppression layer, and the insulator with which the magnetization rotation suppression layer touched between at least two magnetic substance, and is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer has touched through at least one conductor, and inserts in the aforementioned conductor as the feature. [Claim 3] The magnetic resistance element characterized by the electric resistance between the two magnetic substance into which the 1st magnetic substance with which the magnetization rotation suppression layer touched between at least two magnetic substance, and the 2nd magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer are in contact with through at least one conductor, and at least one of the aforementioned conductors inserts the aforementioned conductor by pouring or induction of an electron or a hole changing. [Claim 4] The magnetic resistance element

according to claim 1 to 3 to which the aforementioned magnetization rotation suppression layer is characterized by the bird clapper from at least one chosen from the antiferromagnetic substance, the laminating ferrimagnetic substance, or the high holding power magnetic substance. [Claim 5] The magnetic resistance element according to claim 1 to 4 to which the aforementioned conductor is characterized by being Si thin line. [Claim 6] The magnetic resistance element characterized by resistance changing with change of the magnetization relative angle of the two magnetic substance which the 1st magnetic substance with which the magnetization rotation suppression layer touched between at least two magnetic substance, and the 2nd magnetic substance which is not in contact with the aforementioned magnetization rotation suppression layer constitute the layered product through at least one conductor, and sandwiches the aforementioned conductor. [Claim 7] The magnetic resistance element according to claim 1 to 6 to which the aforementioned conductor is characterized by being a carbon tube. [Claim 8] It is the magnetic memory characterized by to be the magnetic memory equipped with two or more magnetic resistance elements according to claim 1 to 7, and the meanses of the magnetic field seal of approval to the 2nd magnetic substance of the above and meanses to read the magnetization direction of the 2nd magnetic substance of the above, respectively, to arrange the aforementioned magnetic memory on the solid state switch element accumulated on the semiconductor substrate, and to connect it at least at the time of the readout of the aforementioned magnetic memory, or writing.

[Translation done.]